

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

闻泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现  
金购买资产所涉及的合肥裕芯控股有限公司  
部分股权价值评估项目  
**资 产 评 估 报 告**

中联评报字〔2020〕第 615 号

中联资产评估集团有限公司  
二〇二〇年四月十六日

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 资产评估师声明.....              | 1  |
| 摘 要.....                  | 7  |
| 一、委托人、被评估单位和其他报告使用者 ..... | 10 |
| 二、评估目的 .....              | 19 |
| 三、评估对象和评估范围 .....         | 20 |
| 四、价值类型及其定义 .....          | 35 |
| 五、评估基准日 .....             | 36 |
| 六、评估依据 .....              | 36 |
| 七、评估方法 .....              | 38 |
| 八、评估程序实施过程 and 情况 .....   | 51 |
| 九、评估假设 .....              | 52 |
| 十、评估结论 .....              | 53 |
| 十一、特别事项说明 .....           | 58 |
| 十二、评估报告使用限制说明.....        | 60 |
| 十三、评估报告日 .....            | 61 |
| 备查文件目录.....               | 63 |

## 声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

五、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。

六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

七、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及的境内资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

八、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

九、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

## 有关名词释义

| 一、一般名词释义                       |   |                                                            |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 云南融智                           | 指 | 云南融智资本管理有限公司                                               |
| 上海中闻金泰                         | 指 | 上海中闻金泰资产管理有限公司                                             |
| 合肥中闻金泰                         | 指 | 合肥中闻金泰半导体投资有限公司                                            |
| 小魅科技                           | 指 | 上海小魅科技有限公司                                                 |
| 云南省城投                          | 指 | 云南省城市建设投资集团有限公司                                            |
| 上海矽胤                           | 指 | 上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）                                         |
| 鹏欣智澎                           | 指 | 上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）                                           |
| 西藏风格                           | 指 | 西藏风格投资管理有限公司                                               |
| 西藏富恒                           | 指 | 西藏富恒投资管理有限公司                                               |
| 鹏欣智澎及其关联方                      | 指 | 鹏欣智澎、西藏风格和西藏富恒                                             |
| 联合体                            | 指 | 合肥中闻金泰、云南省城投、上海矽胤的统称                                       |
| 目标公司/安世集团/<br>Nexperia Holding | 指 | Nexperia Holding B.V.，持有 Nexperia B.V. 100%股份              |
| 安世半导体/Nexperia                 | 指 | Nexperia B.V.，目标公司的下属境外经营实体公司                              |
| 恩智浦/NXP                        | 指 | NXP Semiconductors N.V.（NASDAQ: NXPI），目标公司前身为 NXP 的标准产品事业部 |
| 合肥裕芯                           | 指 | 合肥裕芯控股有限公司，为持有安世集团股份设立的特殊目的公司                              |
| 裕成控股                           | 指 | 裕成控股有限公司，为持有安世集团股份设立的特殊目的公司                                |
| SPV                            | 指 | Special Purpose Vehicle，特殊目的公司                             |
| 合肥广芯                           | 指 | 合肥广芯半导体产业中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                   |
| 合肥广讯                           | 指 | 合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                 |
| 合肥广合                           | 指 | 合肥广合产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                    |
| 宁波广轩                           | 指 | 宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙），合肥裕芯股东                              |
| 宁波广优                           | 指 | 宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                |
| 宁波益穆盛                          | 指 | 宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙），合肥裕芯股东                             |
| 北京中广恒                          | 指 | 北京中广恒资产管理中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                   |
| 合肥广坤                           | 指 | 合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                 |
| 合肥广腾                           | 指 | 合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                 |
| 合肥广韬                           | 指 | 合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                 |
| 宁波广宜                           | 指 | 宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙），合肥裕芯股东                              |
| 北京广汇                           | 指 | 北京广汇资产管理中心（有限合伙），合肥裕芯股东                                    |

|                       |   |                                              |
|-----------------------|---|----------------------------------------------|
| 建广资产                  | 指 | 北京建广资产管理有限公司                                 |
| 合肥建广                  | 指 | 合肥建广投资管理合伙企业（有限合伙）                           |
| JW Capital            | 指 | JW Capital Investment Fund LP                |
| Gaintime              | 指 | Gaintime International Limited               |
| Lucky Trend           | 指 | Lucky Trend International Investment Limited |
| Wingtech Kaiman       | 指 | Wingtech Kaiman Holding Limited              |
| 智路资本                  | 指 | Wise Road Capital LTD                        |
| 北京中益                  | 指 | 北京中益基金管理有限公司，宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的普通合伙人之一         |
| 合肥芯屏                  | 指 | 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙），北京广汇的有限合伙人                  |
| 京运通                   | 指 | 北京京运通科技股份有限公司                                |
| 宁波圣盖柏                 | 指 | 宁波圣盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）                          |
| 德信盛弘                  | 指 | 德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）                       |
| 谦石铭扬                  | 指 | 宁波谦石铭扬投资合伙企业（有限合伙）                           |
| 建银国际                  | 指 | 建银国际（深圳）投资有限公司，合肥广坤的有限合伙人                    |
| 肇庆信银                  | 指 | 肇庆新区信银股权投资合伙企业（有限合伙）                         |
| 宁波中益                  | 指 | 宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙），合肥广韬的有限合伙人            |
| 宁波益昭盛                 | 指 | 宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙），宁波广宜的有限合伙人           |
| 谦石铭新                  | 指 | 宁波谦石铭新投资合伙企业（有限合伙）                           |
| Bridge Roots Fund     | 指 | Bridge Roots Fund L.P.                       |
| Huarong Core Win Fund | 指 | Huarong Core Win Fund L.P.                   |
| Pacific Alliance Fund | 指 | Pacific Alliance Investment Fund L.P.        |
| 合肥建投                  | 指 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司                            |
| 境内基金                  | 指 | 合肥裕芯的股东                                      |
| 境外基金                  | 指 | JW Capital                                   |
| GP                    | 指 | General Partner，普通合伙人                        |
| LP                    | 指 | Limited Partner，有限合伙人                        |
| 格力电器                  | 指 | 珠海格力电器股份有限公司                                 |
| 国联集成电路                | 指 | 无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）                           |
| 智泽兆纬                  | 指 | 深圳市智泽兆纬科技有限公司                                |
| 珠海融林                  | 指 | 珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）                           |
| 上海矽同                  | 指 | 上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）                           |
| 交易对方                  | 指 | 【建广资产、北京中益、合肥芯屏、袁永刚、宁波中益、宁波益昭盛】              |

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行股份购买资产的交易对方       | 指 | 【合肥芯屏、建广资产】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 发行股份及支付现金购买资产的交易对方  | 指 | 【北京中益、袁永刚、宁波中益、宁波益昭盛】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本次交易的标的资产           | 指 | 【宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 3 支基金中建广资产、北京中益持有的财产份额，以及北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 4 支基金之 LP（或上层实际出资人）持有的财产份额】                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本次交易的标的公司/标的公司/标的企业 | 指 | 【北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 本次交易                | 指 | 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 3 支基金中建广资产、北京中益作为 GP 持有的财产份额，以及【北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 4 支基金之 LP（或上层实际出资人）持有的财产份额】                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 前次交易/前次重大资产重组       | 指 | 【上市公司通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制的交易。在境内，上市公司通过发行股份及支付现金的方式分别收购境内基金之上层出资人的有关权益份额。其中，包括 12 支境内基金中建广资产、合肥建广作为 GP 拥有的全部财产份额（北京广汇、合肥广坤、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜之 LP 不参与本次交易，该等 5 支境内基金中建广资产、合肥建广作为 GP 拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，以及参与交易的 7 支境内基金之 LP（或上层实际出资人）拥有的全部财产份额。在境外，上市公司境外关联方通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为 GP 拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的 LP 份额，在上市公司取得对安世集团的控制权后，上市公司境外关联方通过支付现金的方式收购境外基金之 LP 拥有的全部财产份额。】 |
| ITEC                | 指 | Nexperia 位于荷兰的工业设备研发中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>二、专业名词或术语释义</b>  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 分立器件                | 指 | Nexperia 三大产品线之一，包括双极性晶体管、二极管、ESD 保护器件和 TVS 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 逻辑器件                | 指 | Nexperia 三大产品线之一，包括转换器和模拟开关在内的标准和微型逻辑器件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MOSFET 器件           | 指 | Nexperia 三大产品线之一，包括小信号 MOSFET 和功率 MOSFET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GaN                 | 指 | 氮和镓化合物，一种第三代半导体材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SiC                 | 指 | 硅和碳化合物，一种第三代半导体材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 晶圆                  | 指 | 硅半导体产品制造所用的硅晶片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 封测                  | 指 | 封装和测试，为半导体产品的后端生产环节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IDM 模式              | 指 | 半导体行业垂直整合制造模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabless 模式          | 指 | 半导体行业无晶圆加工线设计模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 英飞凌科技公司             | 指 | 英飞凌科技公司（Infineon），全球领先的德国半导体公司，英文名称为 Infineon Technologies AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 美国德州仪器公司            | 指 | 美国德州仪器公司（TI），全球领先的美国半导体公司，英                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

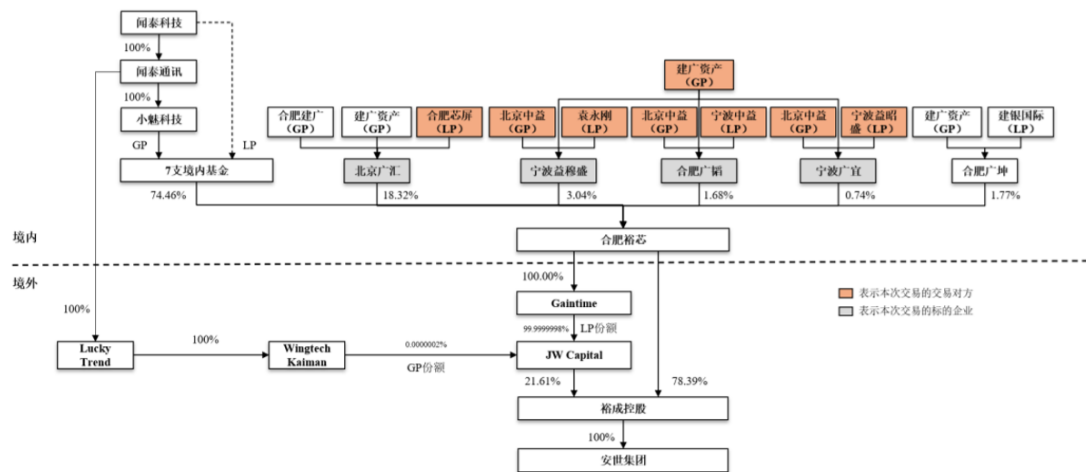
|          |   |                                                           |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|
|          |   | 文名称为 TEXAS INSTRUMENTS INC                                |
| 罗姆株式会社   | 指 | 罗姆株式会社（Rohm），全球领先的日本半导体公司，英文名称为ROHM COMPANY LIMITED       |
| 安森美半导体公司 | 指 | 安森美半导体公司（ON Semi），全球领先的美国半导体公司，英文名称为ON SEMICONDUCTOR CORP |
| IC       | 指 | 集成电路                                                      |
| WSTS     | 指 | 全球半导体贸易协会                                                 |

# 闻泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的合肥裕芯控股有限公司 部分股权价值评估项目 资 产 评 估 报 告

中联评报字〔2020〕第 615 号

## 摘 要

闻泰科技股份有限公司（以下简称：上市公司或委托人）拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯控股有限公司（以下简称：合肥裕芯）的 4 名股东（即 4 支基金）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波益穆盛）、合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称：合肥广韬）、宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）（以下简称：宁波广宜）等 3 支基金中北京建广资产管理有限公司（以下简称：建广资产）、北京中益基金管理有限公司（以下简称：北京中益）作为 GP 拥有的全部财产份额和相关权益，以及北京广汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称：北京广汇）、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 4 支基金之 LP 的全部财产份额。股权结构图如下：



合肥裕芯、Gaintime international limited（以下或简称：Gaintime）、JW Capital Investment Fund LP（以下或简称：JW Capital）合计持有裕成控股有限公司（以下或简称：裕成控股）近 100%股份，裕成控股持有 Nexperia Holding B.V.（以下或简称：安世集团）100%的股份，安世集团下属全资子公司安世半导体是全球领先的半导体标准器件供应商，专注于分立器件、逻辑器件及 MOSFET 器件的设计、生产、销售。安世半导体已形成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商 100%的股份。

中联资产评估集团有限公司接受闻泰科技股份有限公司的委托，就闻泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产取得合肥裕芯控股有限公司部分股权相关权益之经济行为，对合肥裕芯控股有限公司股东全部权益在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。

评估对象为合肥裕芯股东全部权益，评估范围是合肥裕芯的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债等资产及相关负债。

评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合纳入评估范围对象的

实际情况，综合考虑各种影响因素，对合肥裕芯采用资产基础法进行评估，对合肥裕芯所持有的下属经营实体安世集团，采用资产基础法及市场法进行评估，然后加以校核比较以确定安世集团的评估值。

合肥裕芯在评估基准日 2019 年 12 月 31 日合并口径归母所有者权益账面值为 1,140,262.36 万元，评估值 2,984,747.12 万元，评估增值 1,844,484.76 万元，增值率 161.76%。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，即自评估基准日 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日使用有效。超过一年，需重新进行评估。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告全文。

# 闻泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的合肥裕芯控股有限公司 部分股权价值评估项目 资 产 评 估 报 告

中联评报字〔2020〕第 615 号

闻泰科技股份有限公司：

中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法、市场法，按照必要的评估程序，对闻泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产之经济行为所涉及的安世集团股东全部权益在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

## 一、委托人、被评估单位和其他报告使用者

本次资产评估的委托人为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或上市公司），被评估单位为合肥裕芯控股有限公司。

### （一）委托人概况

公司名称：闻泰科技股份有限公司

住所：黄石市团城山 6 号小区

法定代表人：张学政

注册资本：637,266,387 元人民币

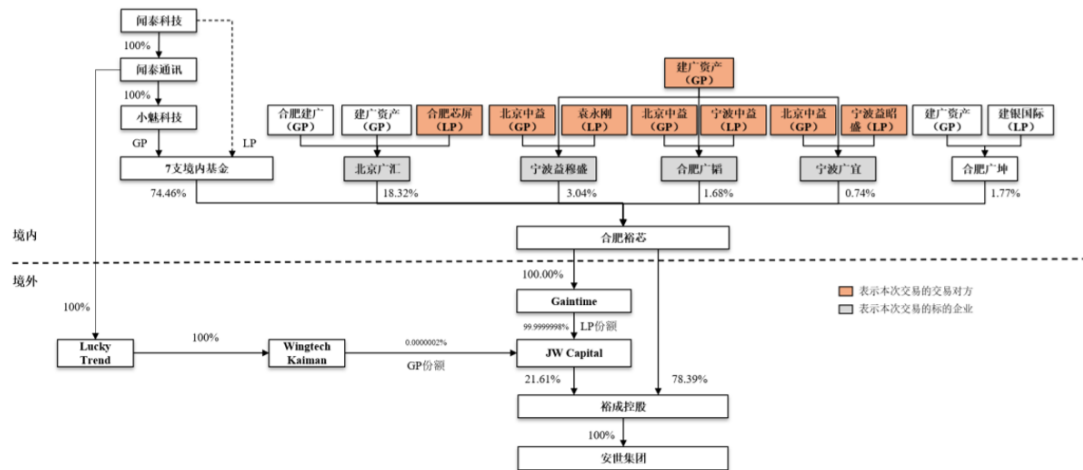
成立日期：1993 年 1 月 11 日

统一社会信用代码：91420000706811358X

经营范围：电子软件产品的开发；房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危化品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## （二）交易背景概况

根据《闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》及委托人提供的交易方案说明，闻泰科技股份有限公司（以下简称：上市公司或委托人）拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯控股有限公司（以下简称：合肥裕芯）的 4 名股东（即 4 支基金）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波益穆盛）、合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称：合肥广韬）、宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）（以下简称：宁波广宜）等 3 支基金中北京建广资产管理有限公司（以下简称：建广资产）、北京中益基金管理有限公司（以下简称：北京中益）作为 GP 拥有的全部财产份额和相关权益，以及北京广汇资产管理中心（有限合伙）（以下简称：北京广汇）、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 4 支基金之 LP 的全部财产份额。股权结构图如下：



合肥裕芯、Gaintime international limited（以下或简称：Gaintime）、JW Capital Investment Fund LP（以下或简称：JW Capital）合计持有裕成控股有限公司（以下或简称：裕成控股）近 100%股份，裕成控股持有 Nexperia Holding B.V.（以下或简称：安世集团）100%的股份，安世集团下属全资子公司安世半导体是全球领先的半导体标准器件供应商，专注于分立器件、逻辑器件及 MOSFET 器件的设计、生产、销售。安世半导体已形成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商 100%的股份。

本次交易中，上市公司收购的合肥裕芯的 4 名股东（即 4 支基金）之上层出资人的有关权益份额，上市公司通过本次收购的上层出资人之 GP 份额和 LP 份额将合计间接持有安世集团 23.78%和各出资主体中除下层投资外的其他净资产 132.03 万元，具体如下：

| 评估主体    | 标的公司        |          |                 | 标的资产     |          | 合计           |               |
|---------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|---------------|
|         | 主体名称        | 持有下级公司股权 | 除持有下级公司股权外其他净资产 | 标的资产范围   | 持有下级公司股权 | 间接持有合肥裕芯股权比例 | 持有各层级资产负债汇总情况 |
| [1]合肥裕芯 | [1.1]北京广汇   | 18.32%   | 99.17           | 合肥芯屏 LP  | 99.9521% | 18.3145%     | 99.13         |
|         | [1.3]宁波益穆盛  | 3.04%    | 28.47           | 袁永刚 LP   | 99.9944% | 3.0362%      | 28.47         |
|         |             |          |                 | 建广资产 GP  | 0.0028%  | 0.0001%      | 0.00          |
|         |             |          |                 | 北京中益 GP  | 0.0028%  | 0.0001%      | 0.00          |
|         | [1.4]合肥广韬   | 1.68%    | 2.21            | 宁波中益 LP  | 99.9972% | 1.6823%      | 2.21          |
|         |             |          |                 | 建广资产 GP  | 0.0014%  | 0.0000%      | 0.00          |
|         |             |          |                 | 北京中益 GP  | 0.0014%  | 0.0000%      | 0.00          |
|         | [1.1.5]宁波广宜 | 0.74%    | 2.22            | 宁波益昭盛 LP | 99.9769% | 0.7418%      | 2.22          |
|         |             |          |                 | 建广资产 GP  | 0.0116%  | 0.0001%      | 0.00          |
|         |             |          |                 | 北京中益 GP  | 0.0116%  | 0.0001%      | 0.00          |
| 合计      |             |          |                 |          |          | 23.7752%     | 132.03        |

### （三）被评估单位概况

公司名称：合肥裕芯控股有限公司

公司地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 楼 292 室

法定代表人：张学政

注册资本：339,654.6357 万

成立日期：2016 年 5 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MA2MW1YQ7U

经营范围：半导体产品和设备、零部件的研发、设计、销售、技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 1. 公司历史沿革

##### （1）公司设立

合肥裕芯控股有限公司于 2016 年 5 月 3 日召开公司初次股东会议，决定由北京广汇投资管理中心（有限合伙）、合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）共同出资设立。于 2016 年 5 月 5 日通过企业名称预先核准审核，并于 2016 年 5 月 6 日取得合肥市工商行政管理局核发的编号为 91340100MA2MW1YQ7U 的营业执照。注册资本 50,000,000.00 元人民币，设立时的股权结构如下：

| 股东名称                | 认缴出资额         | 持股比例（%） |
|---------------------|---------------|---------|
| 北京广汇投资管理中心（有限合伙）    | 25,000,000.00 | 50      |
| 合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙） | 25,000,000.00 | 50      |
| 合计                  | 50,000,000.00 | 100     |

##### （2）股权变更

1) 根据合肥裕芯于 2017 年 2 月 15 日作出的股东会决议, 同意合肥裕芯注册资本增至 330,898.835714 万元, 新增注册资本由北京广汇认缴出资 62,235.9 万元, 合肥广坤认缴出资 6,000 万元, 合肥广芯认缴出资 145,849.2 万元, 合肥广讯认缴出资 41,490.6 万元, 合肥广合认缴出资 20,835.6 万元, 宁波广轩认缴出资 15,000 万元, 宁波广优认缴出资 15,000 万元, 宁波益穆盛认缴出资 10,313.25 万元, 合肥广腾认缴出资 5,940 万元, 合肥广韬认缴出资 57,142,857.14 元, 宁波广宜认缴出资 2,520 万元, 出资方式为货币出资。本次变更后的股权结构如下:

| 股东名称                     | 认缴出资额            | 持股比例 (%) |
|--------------------------|------------------|----------|
| 合肥广坤半导体产业投资中心 (有限合伙)     | 60,000,000.00    | 1.813243 |
| 北京广汇资产管理中心 (有限合伙)        | 622,359,000.00   | 18.80814 |
| 合肥广芯半导体产业投资中心 (有限合伙)     | 1,458,492,000.00 | 44.07667 |
| 合肥广合产业投资中心 (有限合伙)        | 208,356,000.00   | 6.296668 |
| 合肥广讯半导体产业投资中心 (有限合伙)     | 414,906,000.00   | 12.53876 |
| 合肥广韬半导体产业投资中心 (有限合伙)     | 57,142,857.14    | 1.726898 |
| 合肥广腾半导体产业投资中心 (有限合伙)     | 59,400,000.00    | 1.795111 |
| 宁波梅山保税港区广轩投资管理中心 (有限合伙)  | 150,000,000.00   | 4.533108 |
| 宁波梅山保税港区广宜投资管理中心 (有限合伙)  | 25,200,000.00    | 0.761562 |
| 宁波梅山保税港区广优投资中心 (有限合伙)    | 150,000,000.00   | 4.533108 |
| 宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业 (有限合伙) | 103,132,500.00   | 3.116738 |
| 合计                       | 3,308,988,357.14 | 100      |

2) 经 2017 年 3 月 29 日股东会决议, 审议通过《合肥裕芯控股有限公司新增股东和注册资本》的议案, 注册资本变更为 3,396,546,357.14 元人民币, 本次变更后的股权结构如下:

| 股东名称                    | 认缴出资额            | 持股比例 (%) |
|-------------------------|------------------|----------|
| 合肥广坤半导体产业投资中心 (有限合伙)    | 60,000,000.00    | 1.7665   |
| 北京广汇资产管理中心 (有限合伙)       | 622,359,000.00   | 18.32329 |
| 合肥广芯半导体产业投资中心 (有限合伙)    | 1,458,492,000.00 | 42.94044 |
| 合肥广合产业投资中心 (有限合伙)       | 208,356,000.00   | 6.134349 |
| 合肥广讯半导体产业投资中心 (有限合伙)    | 414,906,000.00   | 12.21553 |
| 合肥广韬半导体产业投资中心 (有限合伙)    | 57,142,857.14    | 1.682381 |
| 合肥广腾半导体产业投资中心 (有限合伙)    | 59,400,000.00    | 1.748835 |
| 宁波梅山保税港区广轩投资管理中心 (有限合伙) | 150,000,000.00   | 4.416251 |

|                         |                  |          |
|-------------------------|------------------|----------|
| 宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）  | 25,200,000.00    | 0.74193  |
| 宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）    | 150,000,000.00   | 4.416251 |
| 宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙） | 103,132,500.00   | 3.036393 |
| 北京中广恒资产管理中心（有限合伙）       | 87,558,000.00    | 2.577854 |
| 合计                      | 3,396,546,357.14 | 100      |

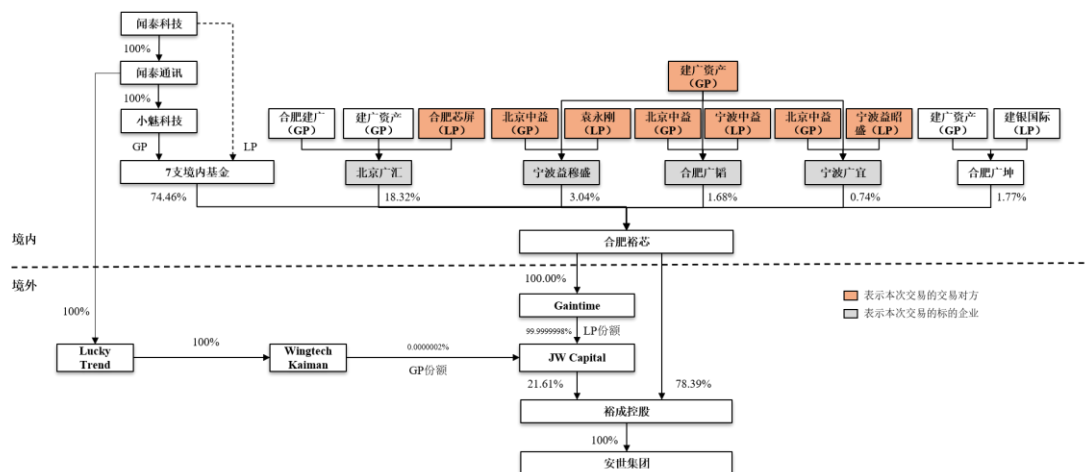
截止 2017 年 3 月 30 日，合肥裕芯控股有限公司已如实收到股东认缴出资的全部款项。截止本报告出具日，合肥裕芯无其他股权变动。

## 2. 经营范围及核心业务概况

合肥裕芯经营范围：半导体产品和设备、零部件的研发、设计、销售、技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），合肥裕芯实际经营实体为目标公司安世集团。

## 3. 股权结构

目前合肥裕芯股权结构图如下：



## 4. 资产、财务及经营状况

合肥裕芯于评估基准日的资产、财务状况如下表：

表1-1 合并报表中资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

| 项目  | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------------|
| 总资产 | 2,412,868.74     | 2,524,287.54     |

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| 负债      | 828,225.66        | 1,382,595.04      |
| 归母所有者权益 | 1,240,249.02      | 1,140,262.36      |
| 净资产     | 1,584,643.08      | 1,141,692.51      |
| 项目      | 2018 年度           | 2019 年度           |
| 营业收入    | 1,043,072.95      | 1,030,731.50      |
| 利润总额    | 166,825.62        | 167,803.71        |
| 净利润     | <b>123,184.63</b> | <b>126,138.00</b> |
| 审计机构    | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）  |                   |

表1-2 母公司资产、负债情况

单位：人民币万元

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 项目   | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 总资产  | 1,142,725.05     | 1,135,884.17     |
| 负债   | 12,912.37        | 68.63            |
| 净资产  | 1,129,812.67     | 1,135,815.54     |
| 项目   | 2018 年度          | 2019 年度          |
| 营业收入 | -                | -                |
| 利润总额 | 13,287.06        | 27,574.72        |
| 净利润  | 11,949.04        | 27,550.78        |
| 审计机构 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |                  |

## 5. 长期股权投资情况

截止评估基准日，合肥裕芯母公司口径下长期股权投资具体情况如下：

表1-3 长期股权投资明细表

单位：人民币元

| 序号 | 被投资单位名称                        | 投资日期       | 持股比例%  | 投资成本          | 账面价值              |
|----|--------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|
| 1  | 裕成控股有限公司                       | 2016/5/4   | 78.39% | 1,632,000,000 | 11,299,084,256.36 |
| 2  | Gaintime international limited | 2019/12/11 | 100%   | 1 港币          | 0.90              |
| 合计 |                                |            |        |               | 11,299,084,257.26 |

合肥裕芯属于半导体制造行业，其经营实体为底层目标公司安世集团。

### （1）长期投资单位介绍

裕成控股有限公司和 Gaintime international limited 均为 SPV，无实际经营业务，除对底层安世集团的长期股权投资外，账面只有部分货币

资金及内部往来所产生的资产和负债。

## 1) 裕成控股有限公司

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司中文名称 | 裕成控股有限公司                                                        |
| 公司英文名称 | YUCHING HOLDING LIMITED                                         |
| 注册地    | 香港                                                              |
| 公司类型   | 有限公司                                                            |
| 公司住所   | Room1305,13/F, TaiTung Building, No.8 Fleming Road, Wanchai, HK |
| 注册号    | 2371867                                                         |
| 注册日期   | 2016 年 5 月 4 日                                                  |
| 股权结构   | 合肥裕芯持有 1,632,000,000 股<br>JW Capital 持有 450,000,000 股           |

裕成控股系持有安世集团 100%股权的控股公司，主营业务为安世集团控股管理。裕成控股设立后的股权结构变动情况如下表所示：

| 变更时间       | 变动事项    | 变更前情况                                    | 变更后情况                                               |
|------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2016.05.06 | 股份转让    | Global Incorporation (HK) Limited 持有 1 股 | 合肥裕芯持有 1 股                                          |
| 2017.02.15 | 第一次增发股份 | 合肥裕芯持有 1 股                               | 合肥裕芯持有 8 股, JW Capital 持有 2 股                       |
| 2017.05.12 | 第二次增发股份 | 合肥裕芯持有 8 股, JW Capital 持有 2 股            | 合肥裕芯持有 1,632,000,000 股, JW Capital 持有 450,000,000 股 |

## 2) Gaintime international limited

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 公司中文名称 | 亨泰国际有限公司                                                                   |
| 公司英文名称 | Gaintime International Limited                                             |
| 注册地    | 香港                                                                         |
| 公司类型   | 有限公司                                                                       |
| 公司住所   | RoomD,3/F.,Thomson Commercial Building,8-10Thomson Road, Wanchai, HongKong |
| 注册号    | 2882271                                                                    |
| 注册日期   | 2019 年 10 月 15 日                                                           |
| 股权结构   | 合肥裕芯持有其 100%的股权                                                            |

Gaintime 系为持有目标公司安世集团股权而设立的特殊目的公司。Gaintime 设立后无股权变动。

### ① JW Capital Investment Fund LP

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | JW Capital Investment Fund LP (JW 资本投资基金有限合伙企业)                                                |
| 公司类型  | Exempted Limited Partnership                                                                   |
| 公司住所  | 4thFloor,HarbourPlace,103SouthChurchStreet,P.O.Box10240,<br>GrandCaymanKY1-1002,CaymanIslandsc |
| 普通合伙人 | Wingtech Kaiman Holding Limited                                                                |
| 注册号   | MC-82882                                                                                       |
| 成立日期  | 2015 年 7 月 24 日                                                                                |
| 认缴出资  | 45,000.0001 万美元                                                                                |
| 合伙人结构 | Gaintime 持有其 99.99%的 LP 份额                                                                     |

JW Capital 系为持有目标公司安世集团股权而设立的特殊目的公司。截止本报告出具日，JW Capital 股权结构如下：

| 合伙人名称                           | 合伙人类别 | 出资金额（万美元） | 出资比例    |
|---------------------------------|-------|-----------|---------|
| Wingtech Kaiman Holding Limited | 普通合伙人 | 0.0001    | 0.00%   |
| Gaintime International Limited  | 有限合伙人 | 45,000    | 100.00% |
| 合计                              | ——    | 45,000    | 100.00% |

#### （四）委托人与被评估单位之间的关系

本次评估的委托人闻泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得合肥裕芯相关权益。

#### （五）委托人、业务约定书约定的其他评估报告使用者

本评估报告的使用者为委托人、被评估单位、经济行为相关的当事方以及按照相关规定报送备案的相关监管机构。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

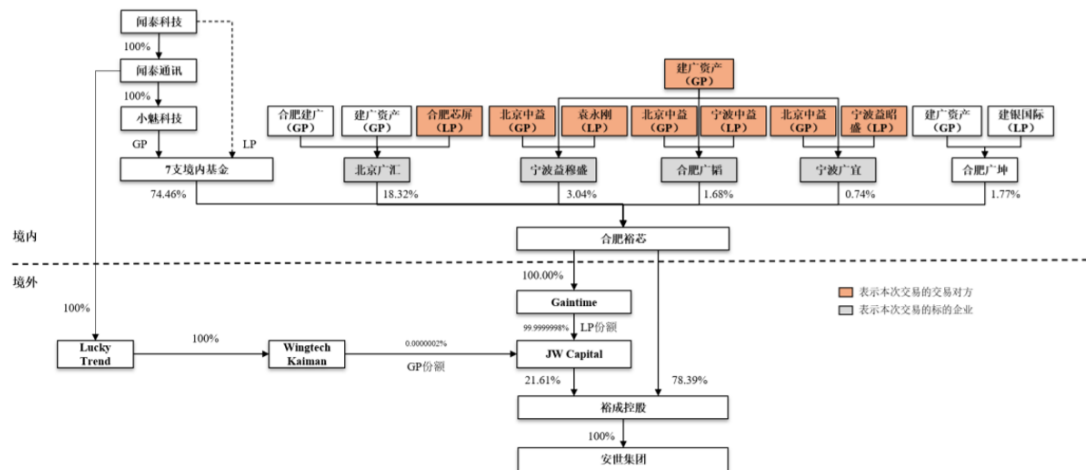
## 二、评估目的

根据《闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》，闻泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买合肥裕芯部分股权。本次评估的目的是反映合肥裕芯股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考依据。

### 三、评估对象和评估范围

#### (一) 评估对象与评估范围内容

根据本次交易方案及交易背景，闻泰科技股份有限公司（以下简称：上市公司或委托人）拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯控股有限公司（以下简称：合肥裕芯）的 4 名股东（即 4 支基金）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波益穆盛）、合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称：合肥广韬）、宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）（以下简称：宁波广宜）等 3 支基金中北京建广资产管理有限公司（以下简称：建广资产）、北京中益基金管理有限公司（以下简称：北京中益）作为 GP 拥有的全部财产份额和相关权益，以及北京广汇资产管理中心（有限合伙）（以下简称：北京广汇）、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 4 支基金之 LP 的全部财产份额。股权结构图如下：



合肥裕芯、Gaintime international limited（以下简称：Gaintime）、JW Capital Investment Fund LP（以下简称：JW Capital）合计持有裕成控股有限公司（以下简称：裕成控股）近 100%股份，裕成控股持有 Nexperia Holding B.V.（以下简称：安世集团）100%的股份，安世集团下属全资子公司安世半导体是全球领先的半导体标准器件供应商，

专注于分立器件、逻辑器件及 MOSFET 器件的设计、生产、销售。安世半导体已形成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商 100%的股份。

安世集团下属主要子公司情况如下：

| 序号 | 公司名称                        | 注册国家或地区    | 中文名称或简称       | 持股比例 (%) | 级次 | 业务性质             |
|----|-----------------------------|------------|---------------|----------|----|------------------|
| 1  | Nexperia B.V.               | 荷兰         | 安世半导体有限公司     | 100%     | 二级 | 半导体产品销售及投资控股     |
| 2  | Nexperia USA Inc.           | 美国         | 安世美国有限公司      | 100%     | 三级 | 半导体产品销售          |
| 3  | Nexperia Taiwan Co.Ltd      | 台湾地区       | 安世台湾有限公司      | 100%     | 三级 | 销售管理             |
| 4  | Nexperia Hungary Kft.       | 匈牙利        | 安世匈牙利有限公司     | 100%     | 三级 | 供应链管理            |
| 5  | Nexperia HongKong Limited   | 中国香港       | 安世香港有限公司      | 100%     | 三级 | 半导体、机械及零配件的组装与销售 |
| 6  | Nexperia Singapore Pte.Ltd. | 新加坡        | 安世菲律宾有限公司     | 100%     | 三级 | 半导体产品销售及质量控制     |
| 7  | Nexperia Germany GmbH       | 德国         | 安世德国有限公司      | 100%     | 三级 | 半导体产品制造及销售       |
| 8  | Nexperia UK Ltd.            | 英国         | 安世英国有限公司      | 100%     | 三级 | 半导体产品制造及销售       |
| 9  | Nexperia China Ltd.         | 中国东莞       | 安世半导体(中国)有限公司 | 100%     | 三级 | 半导体产品制造及销售       |
| 10 | Nexperia Malaysia Sdn.Bhd   | 马来西亚       | 安世马来西亚有限公司    | 100%     | 三级 | 半导体产品制造及销售       |
| 11 | Nexperia Philippines Inc.   | 菲律宾        | 安世菲律宾有限公司     | 100%     | 三级 | 半导体产品制造及销售       |
| 12 | Laguna Ventures Inc.        | 菲律宾 Laguna | Laguna        | 39.996%  | 四级 | 房地产投资            |

注：安世半导体（合肥）有限公司成立于 2018 年 1 月 31 日，其 100%持股母公司是安世半导体有限公司，截止本报告出具日，安世半导体（合肥）有限公司还未开展实际经营业务。

本次评估评估对象是合肥裕芯控股有限公司股东全部权益。评估范围是合肥裕芯控股有限公司在基准日的全部资产及相关负债。

合肥裕芯、JWCapital、Gaintime 以及裕成控股均为 SPV (SpecialPurposeVehicle, 特殊目的公司), 无实际经营业务, 除了对最底层安世集团的长期股权投资, 账面只有部分货币资金及内部往来形成的资产及负债。

合肥裕芯合并口径账面资产总额 2,524,287.54 万元, 负债 1,382,595.04 万元, 净资产 1,141,692.51 万元, 归母所有者权益 1,140,262.36 万元。具体包括流动资产 534,678.62 万元, 非流动资产 1,989,608.93 万元; 流动负债 341,988.24 万元, 非流动负债 1,040,606.80 万元。

单体口径账面资产总额 1,135,884.17 万元, 负债总额 68.63 万元, 净资产 1,135,815.54 万元。

安世集团合并口径账面资产总额 3,079,406.52 万元, 负债 1,382,456.65 万元, 净资产 1,696,949.88 万元。具体包括流动资产 544,788.95 万元, 非流动资产 2,534,617.57 万元; 流动负债 341,849.85 万元, 非流动负债 1,040,606.80 万元。

上述合肥裕芯资产与负债数据摘自经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的合肥裕芯 2018 年度及 2019 年度财务报表审计报告, 安世集团资产与负债数据摘自毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安世集团 2018 年度及 2019 年度财务报表审计报告。评估是在被评估单位经过审计后的基础上进行的。

## (二) 委估主要资产情况

本次评估范围中的主要资产为流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产等。

1. 流动资产主要为货币资金、存货等;

2. 长期股权投资主要为对下层实体的投资, 最底层经营实体为安世集团;

3.流动负债主要是被评估单位在历史经营过程中形成的应交税费及其他应付款。

### （三）实物资产的分布情况及特点

合肥裕芯是控股公司，自身无实际经营业务开展，其经营实体是最底层控股子公司安世集团。安世集团整体纳入评估范围内的实物资产账面值 668,461.03 万元，占安世集团合并口径账面总资产的 21.71%。主要为存货、土地、房屋及建筑物、机器设备、办公设备、在建工程。存货主要为原材料、在产品和产成品；设备类资产为机器设备、办公设备；在建工程主要是各家子公司在经营过程中进行的生产设备或生产线的更新改造。这些资产具有以下特点：

1.实物资产主要分布于安世集团及其下属子公司的经营场所中，分为前端晶圆厂（两家）、后端封测厂（三家）、销售中心、集团总部四类。前端晶圆厂位于德国汉堡 Stresemannallee 101,22529、英国曼彻斯特 Bramhall Moor Lane, Pepper Rd, Hazel Grove, Stockport SK75BJ, 后端封测厂位于广东东莞市黄江镇田美工业园北区 A、马来西亚芙蓉市 No.12687, Tuanku Jaafar Industrial Park, Senawang 71450, Seremban N.S.D.K.47300、菲律宾卡布尧 Light Industry Science Park of the Phils, Philips Avenue, Barrio Diezmo, Cabuyao, 4025, Laguna, Philippines, 销售中心分布于北京、上海、深圳、香港、台湾台北、美国、新加坡等地，集团总部位于荷兰奈梅亨 Jonkerbosplein 52,6534AB Nijmegen。

#### 2.存货

存货分布在安世集团的五家生产工厂中，主要为原材料、在产品和产成品。原材料主要是生产标准分立器件的晶圆片、框架、锡等，实物存货数量较多，单位价值不大，周转情况较好，不存在明显的积压情况；在产品主要是前端晶圆厂提供给后端封测厂的晶圆；产成品是双极性晶

体管和二极管、逻辑及 ESD 保护器件和 MOSFET 器件三类产品线的对应的产品。

### 3.设备类资产

纳入评估范围的设备类资产可分为机器设备、办公设备，其中机器设备主要为前端产线晶圆生产及后端产线封装测试的生产加工设备，办公设备均为被评估单位办公、运营所需的设备。各设备至评估基准日使用正常，企业对设备维护保养情况较好，可满足正常使用的需要。

主要机器设备有：光刻机，刻蚀机，检测设备，抛光机等，设备及其他系统设备均正常运行。

办公设备：主要为电脑、扫描仪、打印机、服务器等办公管理用设备。经现场勘查，实物设备维护保养较好，设备均可正常使用。

### 4.在建工程

在建工程主要为各个工厂的机器设备或生产线的更新，维护。

### 5.土地、房屋及建筑物

土地、房屋及建筑物主要是五家工厂所在地以及生产厂房，前端晶圆厂位于德国汉堡 Stresemannallee 101,22529、英国曼彻斯特 Bramhall Moor Lane, Pepper Rd, Hazel Grove, Stockport SK75BJ, 后端封测厂位于广东东莞市黄江镇田美工业园北区 A、马来西亚芙蓉市 No.12687, Tuanku Jaafar Industrial Park, Senawang 71450, Seremban N.S.D.K. 47300、菲律宾卡布尧 Light Industry Science Park of the Phils, Philips Avenue, Barrio Diezmo, Cabuyao, 4025, Laguna, Philippines, 销售中心分布于北京、上海、深圳、香港、台湾台北、美国、新加坡等地，集团总部位于荷兰奈梅亨 Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen。

表3-1 纳入本次评估范围的土地情况

| 序号 | 权利人 | 坐落 | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 用途 |
|----|-----|----|-------------------------|----|
|----|-----|----|-------------------------|----|

|   |        |                                                                                   |        |      |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1 | 安世马来西亚 | GRN31172, Lot26203, Mukim Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia           | 29,407 | 工业用地 |
| 2 | 安世马来西亚 | GRN31173, Lot26204, Mukim Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia           | 18,392 | 工业用地 |
| 3 | 安世德国   | Stresemannallee 101, Troplowitzstraße, 22529 Hamburg.                             | 42,727 | 建设用地 |
| 4 | 安世德国   | Troplowitzstraße, westlich Troplowitzstraße 14, 22529 Hamburg                     | 974    | 建设用地 |
| 5 | 安世德国   | Stresemannallee, 22529 Hamburg                                                    | 7,302  | 建设用地 |
| 6 | 安世英国   | Land on the north west side of Bramhall Moor Land, Hazel Grove Stockport, England | 73,360 | 设备制造 |
| 7 | LVI    | Brgy. Diezmo, Cabuyao, Laguna, Philippines                                        | 65,882 | 工厂   |

#### (四) 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

截止本次评估基准日，被评估单位下属经营实体安世集团申报的评估范围内账面记录的无形资产为专利及非专利技术、软件、客户关系。专利及非专利技术主要是其应用于终端产品双极性晶体管和二极管、逻辑及 ESD 保护器件和 MOSFET 器件的封装测试过程的专利技术，多由其自身研发取得，还有 2018 年安世集团购买生产氮化镓相关的技术以及加大研发投入使得研发成果资本化转入的无形资产。软件主要是办公软件、存货管理系统软件等。客户关系是 2017 年 2 月安世集团收购安世半导体时进行识别及评估确认。

无形资产中软件、客户关系及部分专利技术列示如下，详细无形资产列示见备查文件中《安世集团及其控股子公司软件、商标、专利情况》：

表3-2 纳入本次评估范围的软件类无形资产

| 序号 | 内容或名称                                      | 取得日期       |
|----|--------------------------------------------|------------|
| 1  | Automation SW                              | 14.11.2017 |
| 2  | MAGMA Software License Yield Manager       | 03.02.2017 |
| 3  | Systema Dispatchingsw System->Software     | 03.02.2017 |
| 4  | IBM Software Automatisierung VM (Phase I)  | 03.02.2017 |
| 5  | IBM Software Automatisierung VM (Phase II) | 03.02.2017 |
| 6  | Replace RS1 & Upgrade Factory Works        | 30.03.2012 |
| 7  | Replace RS1 & Upgrade Factory Works        | 04.05.2012 |
| 8  | Replace RS1 & Upgrade Factory Works        | 01.02.2013 |
| 9  | Replace RS1 & Upgrade Factory Works        | 21.05.2013 |
| 10 | Replace RS1 & Upgrade Factory Works        | 13.08.2014 |
| 11 | FACTORYWORKSSOFTWARE                       | 22.12.1999 |
| 12 | XSITESOFTWARE                              | 22.12.1999 |
| 13 | POWERWORKSSYSTEM                           | 26.06.2001 |
| 14 | GB6216.05.08PAT/SYA Software               | 31.07.2009 |

|    |                                    |            |
|----|------------------------------------|------------|
| 15 | GB6216.05.08PAT/SYASOFTWARE        | 31.12.2010 |
| 16 | GB6213.11.09SIGMAUPGRADE           | 02.07.2010 |
| 17 | GB6203.04.08AutomationSoftware     | 31.07.2009 |
| 18 | GB6203.04.08AutomationSoftware     | 05.03.2010 |
| 19 | GB6213.08.09AUTOMATIONSAAFTWAREPH2 | 31.12.2010 |
| 20 | AUTOMATIONSAAFTWAREPH2             | 02.12.2011 |
| 21 | AUTOMATIONSAAFTWAREPH2             | 02.03.2012 |
| 22 | AUTOMATIONSAAFTWAREPH2             | 21.05.2013 |
| 23 | AUTOMATIONSAAFTWAREPH2             | 16.12.2013 |
| 24 | Equipment Automation               | 16.06.2014 |
| 25 | SPOCK                              | 04.03.2015 |
| 26 | Temptation                         | 04.03.2015 |
| 27 | Temptation                         | 19.05.2016 |
| 28 | SPOCK                              | 07.08.2015 |
| 29 | NL60SAPlicenses                    | 29.06.2017 |
| 30 | NL60Control-Mlicenses              | 20.10.2017 |
| 31 | NL60Techniallicenses               | 13.12.2017 |
| 32 | NL60Tibcollicenses                 | 22.11.2017 |
| 33 | NL60Quintiqlicenses                | 28.12.2017 |
| 34 | NL60JDAllicenses                   | 31.10.2018 |
| 35 | NL60ITQCM                          | 31.10.2018 |
| 36 | NL60ControlMadditionallicenses     | 31.12.2018 |
| 37 | NL60SAPHANA                        | 31.12.2018 |
| 38 | NL60McAfeellicenses                | 30.06.2017 |
| 39 | NL60VmwareLicence                  | 25.07.2017 |
| 40 | NL60SNOWlicenses                   | 30.06.2017 |
| 41 | NL60VMwarelicenses                 | 31.10.2018 |
| 42 | NL60Oraclelicenses                 | 31.10.2018 |
| 43 | NL60DellEMCllicenses               | 31.10.2018 |

表3-3 纳入本次评估范围的部分专利技术和专有技术、客户关系

| 序号 | 内容或名称               | 专利号           | 法定/预计使用年限  |
|----|---------------------|---------------|------------|
| 1  | 共模扼流器               | 2016100342900 | 2036.01.18 |
| 2  | 半导体器件               | 2015108687685 | 2035.12.01 |
| 3  | 具有多个 I/O 侧面可焊接端子的封装 | 2015107112074 | 2035.10.27 |
| 4  | 半导体器件的金属化           | 2015106453781 | 2035.10.07 |
| 5  | 静电放电保护器件            | 2015106329248 | 2035.09.28 |
| 6  | 级联晶体管电路             | 2015106132564 | 2035.09.22 |
| 7  | 半导体器件               | 2015104629619 | 2035.07.30 |
| 8  | 无引线半导体封装和方法         | 2015104549351 | 2035.07.28 |
| 9  | 半导体器件               | 2015102516334 | 2035.05.17 |
| 10 | 腔体内电子发射器件的电极涂层      | 2015101997159 | 2035.04.22 |
| 11 | 具有内部多边形焊盘的封装半导体器件   | 2014106461887 | 2038.04.30 |
| 12 | ESD 保护器件            | 2014105537982 | 2034.10.16 |
| 13 | 半导体器件及其制造方法         | 2014105149578 | 2034.09.28 |
| 14 | 电流控制电路、模块及软启动电路     | 201410418576X | 2034.08.21 |

|    |                                  |               |            |
|----|----------------------------------|---------------|------------|
| 15 | 电场间隙器件及其制造方法                     | 2014102907916 | 2034.06.24 |
| 16 | 电场间隙器件与制造方法                      | 2014102762349 | 2034.06.18 |
| 17 | 级联的半导体器件                         | 2014101364359 | 2034.04.03 |
| 18 | 级联半导体器件                          | 2014100536131 | 2034.02.16 |
| 19 | GaN 高电子迁移率晶体管和 GaN 二极管           | 2013107062818 | 2033.12.18 |
| 20 | 级联电路                             | 2013106844926 | 2033.12.12 |
| 21 | ESD 保护                           | 2013106478332 | 2033.12.03 |
| 22 | 共源共栅半导体设备                        | 2013105872505 | 2033.11.19 |
| 23 | 级联晶体管电路、包括该级联晶体管电路的电路装置、以及功率变换设备 | 2013105815644 | 2033.11.18 |
| 24 | 电子器件及其制造方法                       | 2013102382839 | 2033.06.16 |
| 25 | 分立半导体器件封装和制造方法                   | 2013102055004 | 2033.05.28 |
| 26 | 异质结半导体器件及其制造方法                   | 2013101848812 | 2033.05.16 |
| 27 | 第 13 族氮化物半导体器件及其制造方法             | 2013101670538 | 2033.05.07 |
| 28 | 晶片级-芯片规模封装器件的钝化                  | 2013101605859 | 2033.05.02 |
| 29 | 保护电路                             | 2013101430182 | 2033.04.22 |
| 30 | 具有隔离沟槽的半导体器件                     | 2012105177526 | 2032.12.04 |
| 31 | 电路连接器装置及其方法                      | 2012104952279 | 2032.11.27 |
| 32 | LED 应用的 CMOS 可调过电压 ESD 和冲击电压保护   | 2012104221606 | 2032.10.28 |
| 33 | 与 ESD/过电压/反极性保护相组合的集成先进铜熔丝       | 2012103029407 | 2032.08.22 |
| 34 | IC 管芯、半导体封装、印制电路板和 IC 管芯制造方法     | 2012102721087 | 2032.07.31 |
| 35 | 用于封装半导体管芯的引线框架和方法                | 2012101397550 | 2032.05.07 |
| 36 | ESD 保护装置                         | 2012100164676 | 2032.01.17 |
| 37 | 边缘端接区                            | 2011102308333 | 2031.08.11 |
| 38 | 电涌保护器件                           | 2010800475316 | 2030.10.21 |
| 39 | IC 封装件的分离                        | 2010800692106 | 2030.09.28 |
| 40 | 电路基板的接触结构以及包括该接触结构的电路            | 2008801178216 | 2028.10.21 |
| 41 | 焊盘结构和制造该焊盘结构的方法                  | 2007800420152 | 2027.11.11 |
| 42 | 具有用于隔离和钝化层的支撑结构的半导体器件            | 2006800292111 | 2026.07.30 |
| 43 | 包含 ESD 器件的电子器件                   | 2005800235203 | 2025.07.05 |
| 44 | 沟槽半导体器件及其制造方法                    | 2005800103420 | 2025.03.28 |
| 45 | 沟槽栅晶体管及其制造                       | 2005800074714 | 2025.02.27 |
| 46 | 沟槽绝缘栅场效应晶体管                      | 2004800352236 | 2024.11.25 |
| 47 | 一种开关及其设备                         | 2004800311541 | 2024.10.13 |
| 48 | 沟槽 MOS 结构                        | 2004800171512 | 2024.06.09 |
| 49 | 芯片传送方法与设备                        | 2003801089046 | 2023.12.11 |
| 50 | 半导体器件及其制造方法                      | 38238667      | 2023.09.17 |
| 51 | 半导体器件                            | 2016100522231 | 2026.01.25 |

|    |                                                                                                                   |               |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 52 | 管芯扩展工具及使用该工具扩展晶圆的方法                                                                                               | 2015800468851 | 2025.09.01   |
| 53 | 电子元件及其形成方法                                                                                                        | 2015105182871 | 2025.08.20   |
| 54 | 半导体器件和相关联的制造方法                                                                                                    | 2015102409703 | 2025.05.12   |
| 55 | 半导体器件及制造方法                                                                                                        | 2015102269680 | 2025.05.05   |
| 56 | A cascode transistor circuit                                                                                      | EP3001563     | 申请日起<br>20 年 |
| 57 | Packaged Semiconductor Device with Interior Polygonal Pads                                                        | EP2881984     | 申请日起<br>20 年 |
| 58 | Bondfleckflächenstruktur und Verfahren zu ihrer Herstellung                                                       | EP 2092561    | 申请日起<br>20 年 |
| 59 | ESD-Schutzvorrichtung, Halbleitervorrichtung und integriertes System in einem Paket mit einer solchen Vorrichtung | EP 2130226    | 申请日起<br>20 年 |
| 60 | Halbleiterbauelement                                                                                              | EP 2608268    | 申请日起<br>20 年 |
| 63 | Schutz für eine integrierte Schaltung                                                                             | EP 2335283    | 申请日起<br>20 年 |
| 64 | Graben-Gate-MOSFET und Verfahren zu dessen Herstellung                                                            | EP 2206154    | 申请日起<br>20 年 |
| 65 | Randabschlussregion für Halbleiteranordnung                                                                       | EP 2421044    | 申请日起<br>20 年 |
| 66 | Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit Graben-Gate                                             | EP 2432023    | 申请日起<br>20 年 |
| 67 | ESD-Schutzschaltung                                                                                               | EP 2475008    | 申请日起<br>20 年 |
| 68 | Elektrostatische Schutzvorrichtung                                                                                | EP 2482314    | 申请日起<br>20 年 |
| 69 | Überspannungs-ESD- und Überspannungsschutz mit CMOS-Einstellung für LED-Anwendung                                 | EP 2590218    | 申请日起<br>20 年 |
| 70 | Schutzschaltung gegen Rückströme                                                                                  | EP 2503690    | 申请日起<br>20 年 |
| 71 | Integrierte Kupfersicherung in Kombination mit ESD-/Überspannungs-/Polaritätsumkehrschutz                         | EP 2562812    | 申请日起<br>20 年 |
| 72 | Gruppe 13 Nitrid-Halbleitervorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung                                         | EP 2662884    | 申请日起<br>20 年 |
| 73 | Kaskodenhalbleiterbauelemente                                                                                     | EP 2693639    | 申请日起<br>20 年 |
| 74 | Diskrete Halbleiterbauelementverpackung und Herstellungsverfahren                                                 | EP 2669936    | 申请日起<br>20 年 |
| 75 | Halbleiterbauelement und Herstellungsverfahren dafür                                                              | EP 2942805    | 申请日起<br>20 年 |
| 76 | Elektrodenbeschichtung für Elektronenemissionsvorrichtungen in Hohlräumen                                         | EP 2937887    | 申请日起<br>20 年 |
| 77 | Kaskodenhalbleiterbauelemente                                                                                     | EP 2736170    | 申请日起<br>20 年 |
| 78 | Feldemissionsvorrichtung und Herstellungsverfahren                                                                | EP 2819165    | 申请日起<br>20 年 |
| 79 | Funkenstrecke und Herstellungsverfahren                                                                           | EP 2819166    | 申请日起<br>20 年 |
| 80 | Kaskodenhalbleiterbauelemente                                                                                     | EP 2787641    | 申请日起<br>20 年 |

|     |                                                                                                                     |            |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 81  | Herstellungsverfahren für Halbleitervorrichtung                                                                     | EP 2793265 | 申请日起<br>20 年 |
| 82  | Integrierter FET und Treiber                                                                                        | EP 1360763 | 申请日起<br>20 年 |
| 83  | Halbleiter-Vorrichtungen                                                                                            | EP 1366569 | 申请日起<br>20 年 |
| 84  | Rückkopplungsschaltung für eine Leistungsstellerschaltung                                                           | EP 1568121 | 申请日起<br>20 年 |
| 85  | Schalter                                                                                                            | EP 1678828 | 申请日起<br>20 年 |
| 86  | Chiptransferverfahren und Vorrichtung                                                                               | EP 1588402 | 申请日起<br>20 年 |
| 87  | Feldeffektbauelement                                                                                                | EP 1295342 | 申请日起<br>20 年 |
| 88  | Vereinzelung von IC-Gehäusen                                                                                        | EP 2622635 | 申请日起<br>20 年 |
| 89  | ESD-protection device, a semiconductor device and an integrated system in a package comprising such a device        | EP2130226  | 申请日起<br>20 年 |
| 90  | Protection for an integrated circuit                                                                                | EP2335283  | 申请日起<br>20 年 |
| 91  | ESD protection circuit                                                                                              | EP2475008  | 申请日起<br>20 年 |
| 92  | CMOS adjustable over voltage ESD and surge protection for LED application                                           | EP2590218  | 申请日起<br>20 年 |
| 93  | Group 13 nitride semiconductor device and method of its manufacture                                                 | EP2662884  | 申请日起<br>20 年 |
| 94  | Discrete semiconductor device package and manufacturing method                                                      | EP2669936  | 申请日起<br>20 年 |
| 95  | A cascode transistor circuit                                                                                        | EP3001563  | 申请日起<br>20 年 |
| 96  | Semiconductor device and manufacturing method                                                                       | EP2942805  | 申请日起<br>20 年 |
| 97  | Electric field gap device and manufacturing method                                                                  | EP2819166  | 申请日起<br>20 年 |
| 98  | Semiconductor device and manufacturing method                                                                       | EP2793265  | 申请日起<br>20 年 |
| 99  | Field effect device                                                                                                 | EP1295342  | 申请日起<br>20 年 |
| 100 | Chip transfer method and apparatus                                                                                  | EP1588402  | 申请日起<br>20 年 |
| 101 | SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MAKING A SEMICONDUCTOR DEVICE WITH PASSIVATION LAYERS PROVIDING TUNED RESISTANCE | 10,157,809 | 申请日起<br>20 年 |
| 102 | Heterojunction Semiconductor Device and Manufacturing Method                                                        | 9349819    | 申请日起<br>20 年 |
| 103 | SEMICONDUCTOR DEVICE AND ASSOCIATED METHODS                                                                         | 10,050,034 | 申请日起<br>20 年 |
| 104 | Cascode transistor circuit                                                                                          | 9705489    | 申请日起<br>20 年 |
| 105 | Common Mode Choke                                                                                                   | 10096419   | 申请日起<br>20 年 |

|     |                                                                                       |            |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 106 | Semiconductor Device                                                                  | 9,762,226  | 申请日起<br>20 年 |
| 107 | A Leadless Semiconductor Package and Method                                           | 9443791    | 申请日起<br>20 年 |
| 108 | Package with Multiple I/O Side-Solderable<br>Terminals                                | 9425130    | 申请日起<br>20 年 |
| 109 | Semiconductor device                                                                  | 9461002    | 申请日起<br>20 年 |
| 110 | Semiconductor device                                                                  | 9735290    | 申请日起<br>20 年 |
| 111 | Data transmission system                                                              | 9,837,554  | 申请日起<br>20 年 |
| 112 | Pneumatic Wafer Expansion                                                             | 10,008,397 | 申请日起<br>20 年 |
| 113 | Electrostatic discharge protection device                                             | 9385115    | 申请日起<br>20 年 |
| 114 | Semiconductor arrangement comprising a trench and<br>method of manufacturing the same | 10,056,459 | 申请日起<br>20 年 |
| 115 | SEMICONDUCTOR DEVICE AND A METHOD<br>OF MAKING A SEMICONDUCTOR DEVICE                 | 10,153,365 | 申请日起<br>20 年 |
| 116 | Semiconductor Device and Method of Making a<br>Semiconductor Device                   | 9,947,632  | 申请日起<br>20 年 |
| 117 | Semiconductor Device with Protected Sidewalls                                         | 9,806,034  | 申请日起<br>20 年 |
| 118 | Semiconductor Device and Method of Making a<br>Semiconductor Device                   | 9,929,263  | 申请日起<br>20 年 |
| 119 | Apparatus and Associated Method                                                       | 10,050,101 | 申请日起<br>20 年 |
| 120 | Circuitry with voltage limiting and capacitive<br>enhancement                         | 9941265    | 申请日起<br>20 年 |
| 121 | Layout for device fabrication                                                         | 9570605    | 申请日起<br>20 年 |
| 122 | Trenchmos                                                                             | 10,032,907 | 申请日起<br>20 年 |
| 123 | Method for a Consistent Shallow Trench ETCH<br>Profile                                | 6342428    | 申请日起<br>20 年 |
| 124 | Non-Power-of-Two Gray-Code Counter and Binary<br>Incrementer Therefor                 | 6314154    | 申请日起<br>20 年 |
| 125 | Trench-Diffusion Corner Rounding in a<br>Shallow-Trench (STI) Process                 | 6150234    | 申请日起<br>20 年 |
| 126 | Semiconductor Power Device Manufacture                                                | 6251730    | 申请日起<br>20 年 |
| 127 | Trench-Gate Semiconductor Device                                                      | 6255692    | 申请日起<br>20 年 |
| 128 | Power Transistor Device Having Hot-Location and<br>Cool-Location Temperature Sensors  | 6144085    | 申请日起<br>20 年 |
| 129 | Switching Arrangement and Switch Component for a<br>DC-DC Converter                   | 6175225    | 申请日起<br>20 年 |
| 130 | Semiconductor Element wit Metal Layer                                                 | 6417564    | 申请日起<br>20 年 |
| 131 | Schottky Diode                                                                        | 6583485    | 申请日起<br>20 年 |

|     |                                                                                                                |           |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 132 | Trench-Gate Semiconductor Devices, and Their Manufacture                                                       | 6707100   | 申请日起<br>20 年 |
| 133 | Trench-Gate Semiconductor Devices, and Their Manufacture                                                       | 6855601   | 申请日起<br>20 年 |
| 134 | Manufacture of Semiconductor Devices with Schottky Barriers                                                    | 6825105   | 申请日起<br>20 年 |
| 135 | Trench-Gate Field-Effect Transistors with Low Gate-Drain Capacitance and Their Manufacture                     | 6566708   | 申请日起<br>20 年 |
| 136 | Semiconductor Devices                                                                                          | 6717787   | 申请日起<br>20 年 |
| 137 | Field Effect Transistor Structure and Method of Manufacture                                                    | 6664593   | 申请日起<br>20 年 |
| 138 | Feedback Circuit for Power Switching Circuit                                                                   | 7102337   | 申请日起<br>20 年 |
| 139 | Trench-Gate Semiconductor Devices                                                                              | 7122860   | 申请日起<br>20 年 |
| 140 | Switching Circuit for Handling Signal Voltages Greater Than the Supply Voltage                                 | 7304526   | 申请日起<br>20 年 |
| 141 | Field-Effect Semiconductor Devices                                                                             | 6,600,194 | 申请日起<br>20 年 |
| 142 | Semiconductor Device Having a Plurality Of Resistive Paths                                                     | 6,436,779 | 申请日起<br>20 年 |
| 143 | Manufacture Of Trench-Gate Semiconductor Devices                                                               | 6,498,071 | 申请日起<br>20 年 |
| 144 | Combination Of a Control Unit And a Logic Application, In Which The Combination Is Connected To a System Clock | 6,861,875 | 申请日起<br>20 年 |
| 145 | Edge Termination In a Trench- Gate Mosfet                                                                      | 6,833,583 | 申请日起<br>20 年 |
| 146 | Shallow Trench Isolation Method For Forming Rounded Bottom Trench Corners                                      | 6,544,860 | 申请日起<br>20 年 |
| 147 | Self-Aligned Dual-Oxide Umosfet Device And a Method of Fabricating                                             | 6,551,881 | 申请日起<br>20 年 |
| 148 | Voltage Regulator Circuit                                                                                      | 6222353   | 申请日起<br>20 年 |
| 149 | Voltage Regulator Circuit                                                                                      | 6380721   | 申请日起<br>20 年 |
| 150 | Edge Termination In Mos Transistors                                                                            | 6,936,890 | 申请日起<br>20 年 |
| 151 | Trench Semiconductor Device Manufacture with a Thicker Upper Insulating Layer                                  | 6319777   | 申请日起<br>20 年 |
| 152 | Semiconductor Device                                                                                           | 6559502   | 申请日起<br>20 年 |
| 153 | Trench-Gate Semiconductor Devices And The Manufacture Thereof                                                  | 6,784,488 | 申请日起<br>20 年 |
| 154 | Semiconductor Devices and Their Manufacture                                                                    | 6,780,714 | 申请日起<br>20 年 |
| 155 | Cellular Trench-Gate Field-Effect Transistors                                                                  | 6359308   | 申请日起<br>20 年 |
| 156 | Manufacture of Trench-Gate Semiconductor Devices                                                               | 6368921   | 申请日起<br>20 年 |
| 157 | Semiconductor Device Having a Field Effect Transistor and a Method of Manufacturing Such a                     | 6420755   | 申请日起<br>20 年 |

|     | Device                                                                                                         |            |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 158 | Semiconductor Device with Wettable Corner Leads                                                                | 9,847,283  | 申请日起<br>20 年 |
| 159 | Packaged Semiconductor Device with Interior Polygonal Pads                                                     | 10,056,343 | 申请日起<br>20 年 |
| 160 | Semiconductor Device with Supporting Structure for Isolation and Passivation Layers                            | 8062974    | 申请日起<br>20 年 |
| 161 | Layer Sequence and Method of Manufacturing a Layer Sequence                                                    | 8093097    | 申请日起<br>20 年 |
| 162 | Bond Pad Structure and Method for Producing Same                                                               | 8169084    | 申请日起<br>20 年 |
| 163 | ESD-Protection Device, a Semiconductor Device and an Integrated System in a Package Comprising Such a Device   | 8184415    | 申请日起<br>20 年 |
| 164 | Protection for an Integrated Circuit                                                                           | 8390971    | 申请日起<br>20 年 |
| 165 | Meander Resistor                                                                                               | 8258916    | 申请日起<br>20 年 |
| 166 | Trench Gate Mosfet and Method of Manufacturing the Same                                                        | 8357971    | 申请日起<br>20 年 |
| 167 | Contact Structure for an Electronic Circuit Substrate and Electronic Circuit Comprising Said Contact Structure | 8809695    | 申请日起<br>20 年 |
| 168 | 3D Integration of a MIM Capacitor and a Resistor                                                               | 8901705    | 申请日起<br>20 年 |
| 169 | Methods, Systems and Devices for Electrostatic Discharge Protection                                            | 8810004    | 申请日起<br>20 年 |
| 170 | A Trench-Gate Semiconductor Device                                                                             | 8901638    | 申请日起<br>20 年 |
| 171 | Method for Fabricating an Integrated-Passives Device with a MIM Capacitor and a High-Accuracy Resistor on Top  | 9590027    | 申请日起<br>20 年 |
| 172 | Edge Termination Region of a Semiconductor Device                                                              | 8513733    | 申请日起<br>20 年 |
| 173 | Voltage Regulator with Gate Resistor for Improved Efficiency                                                   | 8324878    | 申请日起<br>20 年 |
| 174 | Semiconductor Device with Gate Trench                                                                          | 8652904    | 申请日起<br>20 年 |
| 175 | ESD Protection Circuit                                                                                         | 8686470    | 申请日起<br>20 年 |
| 176 | ESD Protection Device                                                                                          | 8441031    | 申请日起<br>20 年 |
| 177 | CMOS Adjustable Over Voltage ESD and Surge Protection for LED Application                                      | 9451669    | 申请日起<br>20 年 |
| 178 | Backdrive Protection Circuit                                                                                   | 8,400,193  | 申请日起<br>20 年 |
| 179 | Vertical MOSFET Transistor with a Vertical Capacitor Region                                                    | 8735957    | 申请日起<br>20 年 |
| 180 | Vertical MOSFET Transistor with a Vertical Capacitor Region                                                    | 9129991    | 申请日起<br>20 年 |
| 181 | Integrated Advance Copper Fuse Combined with ESD/Over-Voltage/Reverse Polarity Protection                      | 8711532    | 申请日起<br>20 年 |
| 182 | Protection Circuit                                                                                             | 9203237    | 申请日起         |

|     |                                                                        |           |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|     |                                                                        |           | 20 年         |
| 183 | Group 13 Nitride Semiconductor Device and Method of its Manufacture    | 9147732   | 申请日起<br>20 年 |
| 184 | Trench-Gate Resurf Semiconductor Device and Manufacturing Method       | 9006822   | 申请日起<br>20 年 |
| 185 | Trench-Gate Resurf Semiconductor Device and Manufacturing Method       | 9735254   | 申请日起<br>20 年 |
| 186 | Circuit Connector Apparatus and Method Therefor                        | 8508035   | 申请日起<br>20 年 |
| 187 | Low/High Voltage Selector                                              | 9130553   | 申请日起<br>20 年 |
| 188 | Semiconductor Device Having Isolation Trenches                         | 9048116   | 申请日起<br>20 年 |
| 189 | Cascoded Semiconductor Devices                                         | 8847235   | 申请日起<br>20 年 |
| 190 | Discrete Semiconductor Device Package and Manufacturing Method         | 8981566   | 申请日起<br>20 年 |
| 191 | Discrete Semiconductor Device Package and Manufacturing Method         | 9263335   | 申请日起<br>20 年 |
| 192 | Heterojunction Semiconductor Device and Manufacturing Method           | 9064847   | 申请日起<br>20 年 |
| 193 | Cascode Semiconductor Device                                           | 9268351   | 申请日起<br>20 年 |
| 194 | Current control circuit with in parallel transistor modules            | 9397569   | 申请日起<br>20 年 |
| 195 | Semiconductor Device                                                   | 9386642   | 申请日起<br>20 年 |
| 196 | ESD protection device                                                  | 9230953   | 申请日起<br>20 年 |
| 197 | Semiconductor Device and Manufacturing Method                          | 9917187   | 申请日起<br>20 年 |
| 198 | Cascoded semiconductor devices                                         | 9472549   | 申请日起<br>20 年 |
| 199 | GaN HEMTs and GaN Diodes                                               | 8962461   | 申请日起<br>20 年 |
| 200 | ESD protection                                                         | 9368963   | 申请日起<br>20 年 |
| 201 | Semiconductor device comprising an active layer and a schottky contact | 9305789   | 申请日起<br>20 年 |
| 202 | Electrode Coating for Electron Emission Devices within Cavities        | 9190237   | 申请日起<br>20 年 |
| 203 | Semiconductive device and associated method of manufacture             | 9,911,816 | 申请日起<br>20 年 |
| 204 | Cascoded semiconductor devices                                         | 9190826   | 申请日起<br>20 年 |
| 205 | Cascode Circuit                                                        | 9171837   | 申请日起<br>20 年 |
| 206 | Electric field gap device and manufacturing method                     | 9331028   | 申请日起<br>20 年 |
| 207 | Electric field gap device and manufacturing method                     | 9236734   | 申请日起<br>20 年 |
| 208 | Cascoded Semiconductor Devices                                         | 9116533   | 申请日起         |

|     |                                                                                             |           |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|     |                                                                                             |           | 20 年         |
| 209 | Built-up lead frame package and method of making thereof                                    | 9,640,463 | 申请日起<br>20 年 |
| 210 | Semiconductor Device and Manufacturing Method                                               | 9331155   | 申请日起<br>20 年 |
| 211 | Semiconductor device and method of manufacturing                                            | 9461183   | 申请日起<br>20 年 |
| 212 | ESD Diode Structure                                                                         | 6674129   | 申请日起<br>20 年 |
| 213 | Manufacture of Semiconductor Material and Devices Using that Material                       | 6495421   | 申请日起<br>20 年 |
| 214 | Punch-Through Diode and Method of Processing the Same                                       | 7528459   | 申请日起<br>20 年 |
| 215 | Switching Regulator with Isolated Drivers                                                   | 6603291   | 申请日起<br>20 年 |
| 216 | Operation and Circuitry of a Power Conversion and Control Circuit                           | 7579900   | 申请日起<br>20 年 |
| 217 | Chip Transfer Method and Apparatus                                                          | 7726011   | 申请日起<br>20 年 |
| 218 | Trench MOS Structure                                                                        | 7629647   | 申请日起<br>20 年 |
| 219 | Trench-Gate Transistors and Their Manufacture                                               | 8222693   | 申请日起<br>20 年 |
| 220 | Trench-Gate Transistors and Their Manufacture                                               | 7361555   | 申请日起<br>20 年 |
| 221 | Trench MOSFET                                                                               | 7696599   | 申请日起<br>20 年 |
| 222 | Semiconductor Device and Method of Manufacturing Such a Device                              | 7728404   | 申请日起<br>20 年 |
| 223 | Semiconductor Device and Method of Manufacturing Such a Device                              | 7482669   | 申请日起<br>20 年 |
| 224 | Semiconductor Device and Method of Manufacturing Thereof                                    | 7312526   | 申请日起<br>20 年 |
| 225 | Electronic Device Comprising an ESD Device                                                  | 8159032   | 申请日起<br>20 年 |
| 226 | Trench Semiconductor Device and Method of Manufacturing It                                  | 7394144   | 申请日起<br>20 年 |
| 227 | Integrated Half-Bridge Power Circuit                                                        | 7,459,750 | 申请日起<br>20 年 |
| 228 | Trench-Gate Semiconductor Devices And Their Manufacture                                     | 6,534,367 | 申请日起<br>20 年 |
| 229 | Semiconductor Device Having an Edge Termination Structure and Method of Manufacture Thereof | 8344448   | 申请日起<br>20 年 |
| 230 | Power Semiconductor Devices                                                                 | 7,504,690 | 申请日起<br>20 年 |
| 231 | Trench Insulated Gate Field Effect Transistor                                               | 7408223   | 申请日起<br>20 年 |
| 232 | Trench Field Effect Transistor And Method Of Making It                                      | 7,579,649 | 申请日起<br>20 年 |
| 233 | Insulated Gate Field Effect Transistors                                                     | 7737507   | 申请日起<br>20 年 |
| 234 | Trench-Gate Semiconductor Devices and Their                                                 | 6541817   | 申请日起         |

|     |                                                                                                                         |         |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|     | Manufacture                                                                                                             |         | 20 年         |
| 235 | Field Effect Transistor Circuit And Method Of Operation Of Field Effect Transistor Circuit For Reducing Thermal Runaway | 7843259 | 申请日起<br>20 年 |
| 236 | Semiconductor Devices Including Voltage-Sustaining Space-Charge Zone And Methods Of Manufacture Thereof                 | 7504307 | 申请日起<br>20 年 |
| 237 | Lateral Field-Effect Transistor having an Insulated Trench Gate Electrode                                               | 7671440 | 申请日起<br>20 年 |
| 238 | Semiconductor Device Having a Rectifying Junction and Method of Manufacturing Same                                      | 6417526 | 申请日起<br>20 年 |
| 239 | Singulation of IC Packages                                                                                              | 8809121 | 申请日起<br>20 年 |
| 240 | Leadless Chip Carrier Having Improved Mountability                                                                      | 9418919 | 申请日起<br>20 年 |
| 241 | Passivation for Wafer Level-Chip-Scale Package Devices                                                                  | 8853859 | 申请日起<br>20 年 |
| 242 | Packaged Semiconductor Device with Interior Polygonal Pads                                                              | 9269690 | 申请日起<br>20 年 |
| 243 | Lead for Connection to a Semiconductor Device                                                                           | 9418918 | 申请日起<br>20 年 |
| 244 | Pneumatic Wafer Expansion                                                                                               | 1611512 | 2035.09.03   |
| 245 | Customer Relations Distribution                                                                                         | /       | 1-多年         |
| 246 | Customer Relations OEM                                                                                                  | /       | 1-多年         |
| 247 | Customer Relations EMS                                                                                                  | /       | 1-多年         |

除上述无形资产及备查中无形资产附表外，被评估单位无未申报的账面记录和未记录的无形资产。

#### （五）引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额（或者评估值）

本次评估报告中被评估单位基准日各项资产及负债账面值系众华会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。除此之外，未引用其他机构报告内容。

#### 四、价值类型及其定义

依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

## 五、评估基准日

本项目资产评估的基准日是 2019 年 12 月 31 日。

此基准日是委托人综合考虑相关因素确定的。

## 六、评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据，及评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等，具体如下：

### （一）经济行为依据

《闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》

### （二）法律法规依据

- 1.《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）；
- 2.《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）；
- 3.《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）；
- 4.《中华人民共和国资产评估法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于 2016 年 7 月 2 日通过）；
- 5.《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议通过）；
- 6.《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007 年 11 月 28 日国务院第 197 次常务会议通过）；
- 7.其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等；
- 8.其他适用的相关法律、法规、文件政策、准则及规定。

### （三）评估准则依据

- 1.《资产评估准则-基本准则》（财资〔2017〕43 号）；
- 2.《资产评估职业道德准则》（中评协〔2017〕30 号）；

- 3.《资产评估执业准则-资产评估方法》（中评协〔2019〕35号）
- 4.《资产评估执业准则-资产评估程序》（中评协〔2018〕36号）；
- 5.《资产评估执业准则-资产评估报告》（中评协〔2018〕35号）；
- 6.《资产评估执业准则-资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33号）；
- 7.《资产评估执业准则-资产评估档案》（中评协〔2018〕37号）；
- 8.《资产评估执业准则-利用专家工作及相关报告》（中评协〔2017〕35号）；
- 9.《资产评估执业准则-企业价值》（中评协〔2018〕38号）；
- 10.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协〔2017〕46号）；
- 11.《资产评估价值类型指导意见》（中评协〔2017〕47号）；
- 12.《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协〔2017〕48号）。

#### （四）资产权属依据

- 1.土地使用证；
- 2.专利权证；
- 3.重要资产购置合同或凭证；
- 4.其他参考资料。

#### （五）取价依据

- 1.Bloomberg、Capital IQ 网站数据；
- 2.欧元银行同业拆放利率（EURIBOR）；
- 3.伦敦同业拆借利率（LIBOR）；
- 4.马来西亚、菲律宾等地近几年的 CPI、PPI 指数；
- 5.中联资产评估集团有限公司价格信息资料库相关资料；
- 6.其他参考资料。

#### （六）其它参考资料

- 1.安世集团 2018 年度及 2019 年度财务报表审计报告；

2.合肥裕芯控股有限公司 2018 年度及 2019 年度财务报表审计报告；

3.《资产评估常用方法与参数手册》（机械工业出版社 2011 年版）；

4.wind 资讯金融终端；

5.《投资估价》（[美] Damodaran 著，[加] 林谦译，清华大学出版社）；

6.《价值评估：公司价值的衡量与管理（第 3 版）》（[美] Copeland, T. 等著，郝绍伦，谢关平译，电子工业出版社）；

7.其他参考资料。

## 七、评估方法

### （一）评估方法的选择

依据资产评估准则的规定，企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础法三种方法。收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

本次评估的目的是反映合肥裕芯控股有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为委托人股权转让之经济行为提供价值参考依据，资产基础法从企业购建角度反映了该经济行为所涉及的合肥裕芯控股有限公司的价值，故本次评估可以选择资产基础法进行评估。

本次评估中，合肥裕芯所持有的长期股权投资经营实体安世集团作为全球大型半导体标准件产品全流程生产制造企业，一方面，国内外资本市场已有较为成熟的价值估算体系；另一方面，本次交易在中国 A 股市场上存在业务结构、经营模式、企业规模等经营要素相类似的上市公司，故本次可采用市场法评估安世集团 100%的股权价值，因此本次对安世集团股权价值评估可以选取市场法。

综上，根据本次资产评估的目的、资产业务性质、可获得资料的情况等，采用资产基础法对合肥裕芯进行评估，对合肥裕芯所持有的下属经营实体安世集团，采用资产基础法及市场法进行评估。

## （二）资产基础法介绍

资产基础法，是以在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额作为判断整体资产价值的依据，具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值的方法。

各类资产及负债的评估方法如下：

### 1.流动资产

#### （1）货币资金全部为银行存款和其他货币资金。

对于币种为人民币的货币资金，对银行账户进行函证，并核查银行对账单等凭证，以核实后账面值确定其评估值；对于币种为其他货币的货币资金，对其银行账户进行函证，并核查银行对账单等凭证，以评估基准日中国人民银行公告的外汇汇率中间价换算成人民币后账面值为评估值。

#### （2）应收类账款（应收账款、其他应收款）

评估人员在对应收款核实无误的基础上，对应收款项的客户进行了访谈，并借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等。应收款项可以采用集体认定和个别认定的方法确定评估风险损失。

如果以个别方式认定，则应将应收款的账面金额与估计的未来现金流量现值的数额进行比较。如果应收款的账面金额小于估计的未来现金流量现值的数额，则对该项应收款计提评估风险损失。

如果应收款具有的信用风险特征（包括那些未被单独评估为受损的），则根据其历史损失支出进行集体评估，并根据反映当前经济状况的可观察因素进行调整，确认应收款的评估风险损失。

通过对客户的访谈，关联方往来等有充分理由相信全部能收回的，对于除关联方的第三方的往来款，信用状况良好，因此应收账款的评估风险损失为 0%，应收款项以核查核实后的账面值确认评估值。

### （3）预付账款

评估人员采用查阅相关采购合同、记账凭证等文件资料方式，了解评估基准日至评估现场勘查期间已接受的服务情况。以核实后账面值确定评估值。

### （4）其他流动资产

评估人员通过查验账簿及各类原始凭证，结合相关合同及协议，核实了其他流动资产业务内容的真实性和账面值的准确性。以清查核实后的账面值确认评估值。

## 2.非流动资产

### （1）长期应收款

评估方法同流动资产评估方法第（2）项“应收类款项”。

### （2）长期股权投资

纳入本次评估范围内子公司为裕成控股有限公司、Gaintime international limited、JW Capital Investment Fund LP以及长期股权投资经营实体安世集团。

具体评估方法如下：

资产基础法评估方法为确定被投资单位评估后的股东全部权益，再按持股比例计算安世集团应享有的份额确定该长期股权投资的评估值：

长期股权投资评估值=被投资单位整体评估后净资产评估值×持股比例

净资产评估值为负数的按零值确认其评估值。

各被投资单位评估过程中遵循的评估原则、各项资产及负债的评估过程均与合肥裕芯保持同一标准、同一尺度。对各被投资单位评估时采用的评估方法、评估原则、评估过程、评估结论等详情请见附件01评估说明-合肥裕芯及附件1-1评估说明-安世集团。

对于子公司账面除存货外流动资产评估方法同前述“1.流动资产”评估方法。非流动资产评估方法如下：

#### 1) 存货

存货为原材料、产成品和在产品。

评估人员了解存货收、发和保管核算制度，对存货实施抽查盘点；查验存货有无残次、毁损、积压和报废等情况。收集近期存货市场购置价格及产品销售价格资料以其作为取价参考依据，分析确定评估值。数量以评估基准日实际数量为准。

##### ①原材料

账面值由购买价和合理费用构成。对于近期采购、其价格变化不大的原材料及周转正常的原材料，账面单价接近基准日市场价格加合理费用，以经核实后的账面值确定评估值；对部分积压、待报废的原材料按照可变现价格进行评估；存货跌价准备按照零值评估。

##### ②产成品

评估人员依据市场调查情况和企业提供的资料分析，对于产成品以其完全成本为基础，采用市场法确定评估值。

评估价值=实际数量×市场价格×[1-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×(1-所得税率)×r]

其中r为利润实现风险折扣率，畅销产品为0，正常销售产品为50%，勉强可销售的产品为100%。下列费率计算均按照经审计后的2018年、2019年的会计报表中数据计算。

销售费用率=产品销售费用/营业收入

所得税率按企业现实执行的法定税率

营业利润率=主营业务利润/营业收入

### ③在产品

在产品按实际成本记账，其成本组成内容为生产领用的材料、制造费用、辅助材料和人工费用等。

清查时，评估人员查阅了相关账簿记录和原始凭单，以确认在产品的真实存在及所有权归属。再次，对在产品采取核实采购发票、入库记录、出库记录、材料及成本核算账簿等账务记录，来判断在产品的真实性和核算的准确性。正常流转的在产品，由于生产周期较短，成本升降变化不大，成本结转及时完整，故按核实后的账面值确认评估值。

## 2) 固定资产

### ①房屋建筑物

#### a.重置全价的确定

依据房屋所在地国家统计局发布的 CPI 以及房价指数确定综合调整系数，将原始账面值经系数修正得出房屋的重置全价。

房屋重置价=原始购置价×现指数/购置时指数

#### b.成新率的确定

本次评估房屋建筑物成新率的确定，参照不同结构的房屋建筑的经济寿命年限，并通过对境外各建（构）筑物的远程拍照抽样盘点，对建（构）筑物的整体结构进行勘察，结合建筑物使用状况、维修保养情况，分别评定得出各建筑物的尚可使用年限。

成新率根据房屋已使用年限和尚可使用年限计算。

成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

#### c.评估值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

## ②设备类资产

根据本次评估目的，按照持续使用原则，结合委估设备的特点和资料收集情况，对于设备类资产主要采用指数调整法进行评估。

评估值 = 重置全价 × 综合成新率

aa 重置全价的确定

按设备类别依据相关国家统计局部门发布的 PPI 及相关专业指数等确定综合调整系数，将原始账面值经系数修正得出设备的重置全价。

设备重置价 = 原始购置价 × 现指数 / 购置时指数

ab 成新率的确定

对于专用设备和通用机器设备主要依据设备经济寿命年限、已使用年限，通过对设备使用状况、技术状况的现场勘查了解，确定其尚可使用年限。

成新率 = 尚可使用年限 / (已使用年限 + 尚可使用年限) × 100%

ac 评估值的确定

评估值 = 重置全价 × 综合成新率

## ③土地

本次根据企业提供的相关资料，补充土地清查评估明细表，进行账表核对，并核对宗地用途、坐落地点、面积等，查看相关权证资料等。由于疫情影响，评估人员通过境外工作人员拍照进行远程核查。

根据远程核查结果和有关资料的收集情况，境外土地市场交易不活跃，未能获取近期类似土地交易案例或政府发布的地价信息。结合评估目的，本次估价对象主要选用价格指数调整法进行评估。

根据现场勘查和有关资料的收集情况，结合评估目的，价格指数调整法主要是依据当地统计部门发布的 CPI 及房价指数确定综合调整系数，将原始账面值经系数修正得出土地的价值。

土地重置价 = 原始购置价 × 现值指数 / 购置时指数

#### ④在建工程

对于属于正常在建状态下的工程项目，本次评估以经核实后的账面价值并考虑合理资金成本作为评估值，开工日至评估基准日不满 6 个月的不考虑资金成本。

### 3) 无形资产

截止本次评估基准日，被评估单位申报的评估范围内账面记录的无形资产为专利及非专利技术、软件、客户关系。

#### ①评估方法

被评估单位账面无形资产种类较多，对企业的日常运营贡献程度不同，依据资产评估准则的规定，确定无形资产价值的评估方法包括收益法、市场法和成本法三种基本方法及其衍生方法。本次评估依据无形资产的类别，采用不同的评估方法进行评估。

成本法是把现行条件下重新形成或取得被评估资产在全新状况下所需承担的全部成本（包括机会成本）、费用等作为重置价值，然后估测被评估资产业已存在的各种贬值因素，并将其从重置价值中予以扣除而得到被评估资产价值的评估方法。对专利权而言，由于其投入与产出具有弱对应性，有时研发的成本费用较低而带来的收益却很大。相反，有时为设计研发某项专利的成本费用很高，但带来的收益却不高。因此成本法一般适用于开发时间较短尚未投入使用或后台支持性软件著作权及专利权的评估，本次纳入评估范围的软件主要是被评估单位的 SAP 系统（systems applications and products in data processing）和存货管理系统，属于后台支持性软件，因而本次对软件采用成本法进行评估作价。

市场法是指利用市场上同类或类似资产的近期交易价格，经直接比较或类比分析以估测资产价值的评估方法。其采用替代原则，要求充分利用类似资产成交的价格信息，并以此为基础判断和估测被评估资产的价值。从专利及非专利技术、客户关系以及未执行订单交易情况看，交

易案例较少，因而很难获得可用以比照的数个近期类似的交易案例，市场法评估赖以使用的条件受到限制，故目前一般也很少采用市场法评估专利及非专利技术、客户关系。

收益法以被评估无形资产未来所能创造的收益现值来确定评估价值，对专利及非专利技术、客户关系以及与被评估单位日常经营密切相关的软件等无形资产而言，其价值主要来源于直接变卖该等无形资产的收益，或者通过使用该等无形资产为其产品或服务注入技术加成而实现的超额收益。本次评估考虑到被评估单位所经营业务与待评估专利及非专利技术、客户关系等无形资产之间的关联较为显著，纳入本次评估范围的专利及非专利技术、客户关系对其主营业务的价值贡献水平较高，且该等无形资产的价值贡献能够保持一定的延续性，故采用收益法对纳入本次评估范围的专利及非专利技术、客户关系两类无形资产进行评估。

## ②评估模型

### A 收入分成法模型

采用收入分成法较能合理测算被评估单位专利权的价值，其基本公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{K \times R_i \times (1-T)}{(1+r)^i}$$

式中：

P：待评估专利权的评估价值；

R<sub>i</sub>：基准日后第 i 年预期专利权收益；

K：专利权综合分成率；

n：待评估专利权的未来收益期；

i：折现期；

r：折现率。

## B 超额收益法模型

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{K \times R_i}{(1+r)^i}$$

式中：

P——待估无形资产的评估价值；

R<sub>i</sub>——无形资产对应的第 i 年超额收益；

K——无形资产对超额收益的贡献率；

n——无形资产的收益期限；

i——无形资产的折现期；

r——无形资产的折现率。

### 4) 开发支出

对于开发支出的评估，评估人员查阅明细账中相关记录及原始凭证，核实支付内容及性质，在核实支出无误的基础上，按照账面值作为评估值。

### 5) 长期待摊费用

对于长期待摊费用的评估，评估人员查阅明细账中相关记录及原始凭证，核实支付内容、摊销期限及尚存受益期限，在核实支出和摊销政策无误的基础上，按照基准日尚存在的剩余资产或权益作为评估值。

### 6) 递延所得税资产

对递延所得税资产的评估，评估人员核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以证实递延所得税资产的真实性和完整性。在核实无误的基础上，以核实后账面值确定为评估值。

### 7) 其他非流动资产

评估人员通过查验账簿及各类原始凭证，结合相关合同及协议，核实了其他流动资产业务内容的真实性和账面值的准确性。以清查核实后

的账面值确认评估值。

### 3.负债

检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

## （三）市场法简介

### 1.概述

企业价值评估中的市场法，是指将被评估单位与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定被评估单位价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定被评估单位价值的具体方法。

可比上市公司选择标准是在公开、交易活跃的市场上，选择可比公司，这些可比公司与被评估单位的业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素相同或相似。

合肥裕芯所持有的长期股权投资经营实体安世集团作为全球大型半导体标准件产品全流程生产制造企业，一方面，国内外资本市场已有较为成熟的价值估算体系；另一方面，本次交易在中国 A 股市场上存在业务结构、经营模式、企业规模等经营要素相类似的上市公司，故本次可采用市场法评估安世集团 100%的股权价值，因此本次对安世集团股权价值评估可以选取市场法，本次评估中选择国内上市的半导体行业的同质公司作为可比公司。

### 2.评估思路

### （1）可比公司的选择原则

根据《资产评估执业准则-企业价值》的要求，市场法评估应当选择与被评估单位有可比性的公司或者案例。本次评估确定的可比公司选择原则如下：

- 1）同处一个行业，受相同经济因素影响；
- 2）企业业务结构和经营模式类似；

本次评估，通过公开信息搜集选取了具有同质业务的公开上市公司作为可比公司。

### （2）分析、选择并计算各可比对象的价值比率

就价值比率而言，价值比率有市盈率、市净率、市销率与企业价值与折旧摊销息税前利润比率等。本次评估结合被评估单位所处行业分类、行业经济特征以及历史情况进行了线性回归分析，选择相对合适的价值比率。

### （3）进行可比公司的修正

可比公司与被评估单位虽然处于同一行业，但在企业规模，经营情况等方面存在差异，故而需要进行修正从而使得可比公司与被评估单位更加具有可比性。

### （4）流动性折扣选取

本次评估选用上市公司比较法，而被评估单位本身并未上市，其股东权益缺乏市场流通性，因此需要进行扣除流动性折扣修正。

评估人员参考《Measuring the Discount for Lack of Marketability for Non-controlling, Nonmarketable Ownership Interests》中的 Valuation Advisors Pre-IPO Study 研究，对公司 IPO 前 2 年内发生的股权交易的价格与 IPO 后上市后的交易价格的差异进行测算来定量估算流动性折扣。根据 Business Valuation Resource 数据库统计的可比公司所在市场的整体情况，并考虑被评估单位的特点及基准日证券市场状况，选取本次评

估的流动性折扣率。

### (5) 股东权益价值的估算

根据可比公司修正后的价值比率，计算平均价值比率，结合可比公司单位调整系数以及安世集团基准日时点 EBITDA、归母净资产、营业总收入、付息债务规模、货币资金规模、少数股东权益、流动性折扣、溢余及非经营性资产（负债）等，计算得出每个价值比率对应的股东权益价值。然后将每个价值比率计算得出的股东权益价值进行简单加权平均，得到安世集团股东权益价值。

### 3. 评估模型

本次市场法评估估算评估对象权益价值的基本公式为：

#### (1) 价值比率 1 对应的权益价值 $P_1$

$$P_1 = F + C_1 \quad (1)$$

$$F = (EV - DEBT + CASH - M) \times (1 - \delta) \quad (2)$$

$$EV = (EV_x / EBITDA_x) \times EBITDA \quad (3)$$

式中：

$P_1$  - 按照 EV/EBITDA 比率计算的安世集团股东权益价值；

F - 经营性资产价值；

EV - 安世集团企业价值；

DEBT - 安世集团付息债务；

CASH - 安世集团货币资金；

$\delta$  - 流动性折扣；

$C_1$  - 扣除货币资金的溢余或非经营性资产（负债）；

M - 纳入合并报表范围的少数股东权益价值；

$EV_x / EBITDA_x$  - 可比公司单位修正系数后 EV/EBITDA。

#### (2) 价值比率 2 对应的权益价值 $P_2$

$$P_2 = P_b \times (1 - \delta) + C_2 \quad (4)$$

$$P_{bx} = (P_x/B_x) \times B \quad (5)$$

$$P_b = P_{bx} \times X \quad (6)$$

式中：

$P_2$  - 按照 P/B 比率计算的安世集团股东权益价值；

$P_b$  - 经过单位调整系数调整的经营性资产价值；

$P_x/B_x$  - 可比公司 P/B；

$\delta$  - 流动性折扣；

$X$  - 可比公司单位调整系数；

$C_2$  - 溢余或非经营性资产（负债）净值；

$B$ ：安世集团基准日时点归母净资产；

### **（3）价值比率 3 对应的权益价值 $P_3$**

$$P_3 = P_s \times (1 - \delta) + C_2 \quad (7)$$

$$P_{sx} = (P_x/S_x) \times B \quad (8)$$

$$P_s = P_{sx} \times X \quad (9)$$

式中：

$P_3$  - 按照 P/S 比率计算的安世集团股东权益价值；

$P_s$  - 经过单位调整系数调整的经营性资产价值；

$P_x/S_x$  - 可比公司 P/S；

$\delta$  - 流动性折扣；

$X$  - 可比公司单位调整系数；

$C_2$  - 溢余或非经营性资产（负债）净值；

$S$  - 安世集团基准日时点营业收入。

$$P = (P_1 + P_2 + P_3) / 3 \quad (10)$$

式中：

$P$  - 安世集团股东权益价值。

## 八、评估程序实施过程 and 情况

整个评估工作分四个阶段进行：

### （一）评估准备阶段

1. 委托人召集本项目各中介协调会，有关各方就本次评估的目的、评估基准日、评估范围等问题协商一致，并制订出本次资产评估工作计划。

2. 配合企业进行资产清查、填报资产评估申报明细表等工作。评估项目组人员对委估资产进行了详细了解，布置资产评估工作，协助企业进行委估资产申报工作，收集资产评估所需文件资料。

### （二）现场评估阶段

1. 通过现场会议、电话、视频会议、邮件等方式听取委托人及被评估单位有关人员介绍企业总体情况和委估资产的历史及现状，了解企业的财务制度、经营状况、固定资产技术状态等情况。

2. 企业管理层开通评估项目资料虚拟数据库，并根据评估人员提供的资料清单准备，上传评估所需企业财务、法律、工商等资料，评估人员对企业提供的相关资料进行确认、鉴别，并与企业有关财务数据进行核对，对发现的问题通过电话、视频会议、邮件等方式向企业管理层进行咨询并得到相应答复。

3. 根据资产清查评估申报明细表，对被评估单位国内东莞工厂的固定资产、存货进行了现场抽查盘点，对其境外经营实体的固定资产和工厂运营情况，通过获取内部盘点记录、电话访谈当地的工厂负责人及远程抽盘进行了核查。

4. 查阅通过虚拟数据库所收集委估资产的产权证明文件。

5. 根据委估资产的实际状况和特点，确定各类资产的具体评估方法。

6. 对评估范围内的资产及负债，在清查核实的基础上做出初步评估测算。

7.在尽职调查和资产清查过程中，本次评估对价值量大、主要的存货采用了抽查核实的方法，依据其执行有效的存货内控制度，结合抽查情况得出了存货的基准日账面数量及计价可靠性。

8.在尽职调查和资产清查过程中，评估人员对房屋、设备进行了清查核实，其主要生产设施基本能够正常工作。评估人员受到专业及技术条件限制未对设备进行检测。

### （三）评估汇总阶段

对各类资产评估及负债审核的初步结果进行分析汇总，对评估结果进行必要的调整、修改和完善。

### （四）提交报告阶段

在上述工作基础上，起草初步资产评估报告，初步审核后与委托人就评估结果交换意见，在独立分析相关意见后，按评估机构内部资产评估报告审核制度和程序进行修正调整，最后出具正式资产评估报告。

## 九、评估假设

本次评估中，评估人员遵循了以下评估假设：

### （一）一般假设

#### 1.交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

#### 2.公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

#### 3.资产持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

## （二）特殊假设

1. 预测期内被评估单位主要经营实体所在国家的国内政局及国际关系稳定，各自现行的宏观经济以及产业政策、贸易政策、税收政策等除新型冠状病毒肺炎疫情影响外，不发生其他重大变化。

2. 预测期内人民币及其他相关货币之间的汇率与基准日相比不发生较大变化。

3. 被评估单位及其子公司主营业务所涉及的市场环境及竞争关系与基准日相比不发生较大变化。

4. 被评估单位在未来经营期内的管理层尽职、核心成员稳定，维持现状按预定的经营目标持续经营。被评估单位与当前供应商、客户保持正常的商业合作关系，不会对被评估单位的业务开展、成本控制等经营活动造成重大影响。

5. 本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、合法、完整。

6. 可比公司信息披露真实、准确、完整，无影响价值判断的虚假陈述、错误记载或重大遗漏。

7. 评估人员仅基于公开披露的可比公司相关信息选择对比维度及指标，并未考虑其他事项对被评估单位价值的有益影响。

当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

## 十、评估结论

基于产权持有人及企业管理层对未来发展趋势的判断及经营规划，根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对合肥裕芯纳入评估范围的资产实施了清查核实、实地查勘、市

场调查和询证、评定估算等评估程序，得出如下结论。

### （一）评估结论

采用资产基础法，得出被评估单位母公司在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的评估结论：

总资产账面值 1,135,884.17 万元，评估值 2,984,815.75 万元，评估增值 1,848,931.58 万元，增值率 162.77%。

负债账面值 68.63 万元，评估值 68.63 万元，评估增值 0 万元。

净资产账面值 1,135,815.54 万元，评估值 2,984,747.12 万元，评估增值 1,848,931.58 万元，增值率 162.78%。详见下表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

| 项目  |                   | 账面价值                | 评估价值                | 增减值                 | 增值率%          |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |                   | B                   | C                   | D=C-B               | E=D/B×100%    |
| 1   | 流动资产              | 5,975.75            | 5,975.86            | 0.11                | 0.00          |
| 1-1 | 银行存款              | 5,975.75            | 5,975.86            | 0.11                | 0.00          |
| 2   | 非流动资产             | 1,129,908.43        | 2,978,839.90        | 1,848,931.47        | 163.64        |
| 2-1 | 长期股权投资            | 1,129,908.43        | 2,978,839.90        | 1,848,931.47        | 163.64        |
| 3   | <b>资产总计</b>       | <b>1,135,884.17</b> | <b>2,984,815.75</b> | <b>1,848,931.58</b> | <b>162.77</b> |
| 4   | 流动负债              | 68.63               | 68.63               | -                   | -             |
| 5   | 非流动负债             | -                   | -                   | -                   | -             |
| 6   | <b>负债总计</b>       | <b>68.63</b>        | <b>68.63</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
| 7   | <b>净资产（所有者权益）</b> | <b>1,135,815.54</b> | <b>2,984,747.12</b> | <b>1,848,931.58</b> | <b>162.78</b> |

鉴于闻泰科技已通过前次收购取得了合肥裕芯实际经营主体安世集团控制权（即：2019年6月21日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1112号）），提请报告使用者关注本次交易中可能存在的控制权折溢价的影响。

### （二）增值原因分析

合肥裕芯在评估基准日2019年12月31日合并口径归母所有者权益

账面值为 1,140,262.36 万元，评估值 2,984,747.12 万元，评估增值 1,844,484.76 万元，增值率 161.76%。

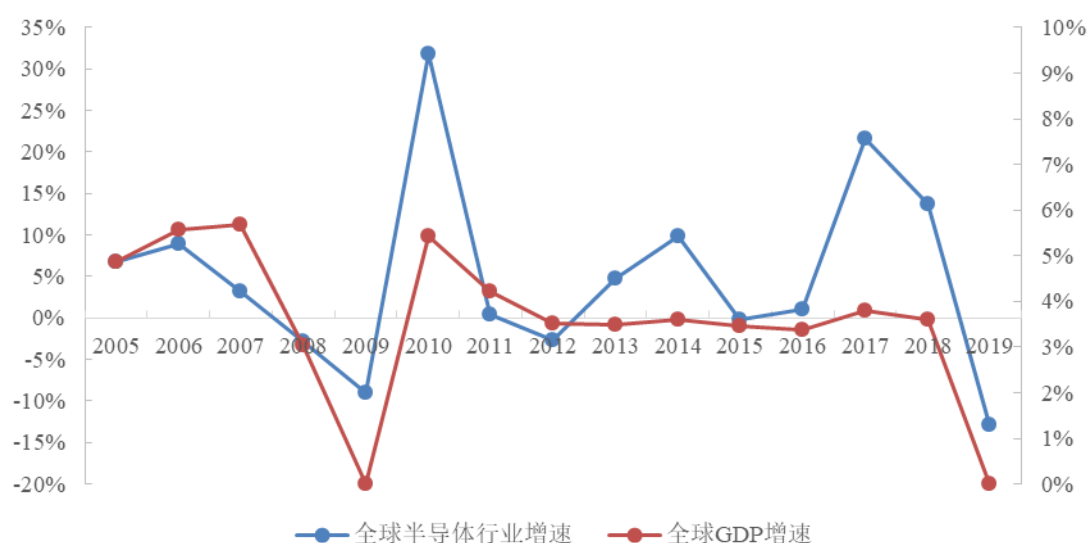
被评估单位的评估结果较其净资产账面值增值较高，主要原因是被评估单位下属经营实体安世集团评估结果增值较高导致的。安世集团的主要价值除了账面的固定资产、存货、营运资金等有形资产外，还包括企业管理、人才团队、品牌优势、政策优惠等重要的无形资源，两类资产在被评估单位价值实现过程中协同发挥作用，使得被评估单位的价值在半导体行业整体发展过程中得到有效凸显。具体体现在以下几个方面要体现在以下几个方面：

## 1. 行业的增长

### （1）全球半导体集成电路市场

2010 年以来，以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的兴起，以及汽车电子、工业控制、仪器仪表、智能照明、智能家居等物联网市场的快速发展，带动整个半导体行业规模迅速增长。

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2018 年全球半导体行业销售收入实现高速增长，销售额达到 4,688 亿美元。



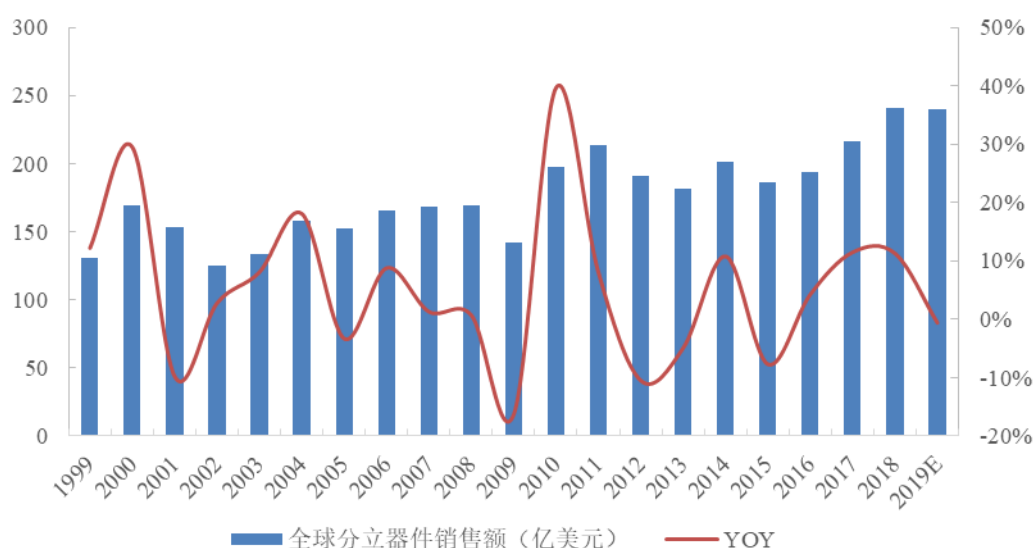
注释：Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS），华泰证券研究所

## 1999~2019 年全球集成电路市场销售规模及增速

## (2) 全球半导体分立器件市场

分立器件作为半导体产业的基本产品门类之一，能够实现对电流、电压、频率、相位、相数等进行变换和控制，以实现整流、逆变、斩波、开关、放大等各种功能。分立器件及逻辑器件作为半导体产品中重要的功能元器件，主要应用在汽车、工业、航空航天、军事等对电子元件的可靠性、耐久性要求极高的场合。分立器件产品作为电子产品的基础元件，具有应用领域广、用量大等特点。光伏、智能电网、汽车电子、消费电子等不同应用领域对不同规格、种类和功能的产品有着多元化的需求。半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。半导体分立器件由于功能的明确性，其属于半导体市场的细分市场。

全球半导体贸易协会（WSTS）预计 2018 年分立器件销售规模分别为 241 亿美元，较上年分别增长 11.3%。半导体分立器件在全球半导体市场中占比约 5%-6%。



注释：Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）

## 1999 年-2019 年全球分立器件销售额

从应用结构发展分析来看，工业控制和汽车电子是两个增长最快的应用领域。汽车电子领域，以自动驾驶为终极目标将驱动汽车使用更多的感应和控制系统，从而带动通用分立器件在汽车领域的增长。网络通信领域，物联网设备及 5G 网络通信的发展将成为新的增长动力。计算机领域，大数据、云计算带动的服务器需求将成为该领域通用分立器件产品在该领域的主要增长动力。而对于消费电子领域，智能电视、智能家居相关产品、可穿戴设备，VR 设备的发展都将成为通用分立器件产品市场新的增长点。

## 2.被评估单位的核心竞争力

### （1）最大的专注于标准器件生产的半导体企业

安世集团专注于半导体标准器件，包括分立器件、逻辑器件及 MOSFET 器件的设计、生产、制造；凭借专注和积累，能为客户稳定提供大批量高可靠性的半导体标准器件，专注于满足客户对于半导体标准器件的需求。

### （2）拥有全球领先的半导体生产工艺及可靠性

作为一家全球领先的高科技半导体企业，安世集团在分立器件、逻辑器件及 MOSFET 器件设计、生产、制造等方面处于行业前列。安世集团前身为恩智浦的标准产品事业部，拥有 60 多年的半导体行业专业经验，其覆盖了半导体产品的设计、制造、封装测试的全部环节，逻辑器件、分立器件和 MOSFET 器件的产品性能由结构设计、晶圆加工和封装共同决定，供应商需采用 IDM 模式才能更好的实现产品性能具备竞争力。

### （3）持续稳定大批量交付，提供半导体领域一站式服务

丰富的产品线是标准逻辑器件产品、通用分立器件和 MOSFET 器件供应商的核心竞争力之一。安世集团拥有丰富的产品组合，可满足客户分立器件、逻辑器件及 MOSFET 器件的一站式采购需求。安世集团自主

生产业内领先的小型封装产品，集高能效与高品质于一体，同时其生产制造的半导体产品满足汽车行业严格的要求标准。同时，安世集团是全球少数几家能够实现大规模量产的半导体公司之一，年产销器件850亿片。从产品应用领域来看，安世集团覆盖了工业、汽车、消费电子、网络通信、计算机等应用领域，产品线较丰富。

## 十一、特别事项说明

### （一）未决诉讼及仲裁事项

菲律宾劳工和就业部认定安世菲律宾存在签署单纯劳务合同（Labour-only contracting）的情形，要求安世菲律宾将涉及的801名用工规范调整为正式员工，安世菲律宾已就此提起申诉。截至2019年3月1日，该申诉仍在审理中。

本次评估未考虑上述事项的影响。

### （二）股权质押事项

合肥裕芯下属经营实体安世集团，安世集团于2019年8月23日与安世半导体（作为借款人）、Bank of America Merrill Lynch International Limited与HSBC Bank Plc（作为全球协调及簿记管理人）、ABN AMRO（作为代理行及担保代理行）签署《借款协议》，约定Bank of America Merrill Lynch International Limited与HSBC Bank Plc代表境外银团向安世集团及安世半导体提供金额为270,660,000欧元及650,000,000美元的定期贷款，以及金额为550,000,000.00美元的循环贷款，并将安世半导体、安世德国、安世美国的全部股权及安世英国的部分股权进行股权质押。

### （三）新型冠状病毒肺炎疫情对评估核查程序的影响

评估基准日后，受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本评估报告日前评估人员未开展境外现场清查、核实工作。

本次评估人员通过虚拟数据库、电话视频会议、邮件等方式对被评

估单位境外资产进行了清查核实，通过现场抽盘、访谈等方式对境内资产进行了现场清查核实。针对本次对境外资产的评估核查所采用的替代性程序，委托人、被评估单位予以确认。待此次疫情过后，评估人员将补充境外现场核查工作程序。

提醒报告使用人注意。

#### （四）新型冠状病毒疫情对安世集团业务开展的影响

合肥裕芯下属经营实体安世集团是是一家总部注册于荷兰的独立法人实体，且在全球开展经营业务，其拥有 5 座重要工厂，分别位于德国、英国、菲律宾、马来西亚以及中国广东，目前新型冠状病毒疫情呈现全球蔓延的趋势，且各国已针对性采取了防控措施。

半导体产业国际化程度高，产业链分布全球，安世集团作为全球运营的公司，生产经营受到各国针对疫情制定的有关政策影响。由于目前尚无法预计疫情结束时间，尚无法评估疫情对安世集团经营业绩的具体影响。

提请报告使用人关注新型冠状病毒疫情对安世集团业务开展产生不利影响的风险。

#### （五）其他需要说明的事项

1.评估机构获得的被评估单位提供的相关资料是本评估报告中无形资产评估的基础。评估师对被评估单位提供的相关资料进行了必要的调查、分析、判断，经过与被评估单位管理层及其主要股东多次讨论，被评估单位进一步修正、完善后，评估机构采信了被评估单位提供相关资料的真实性与可行性。

2.评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人及被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人及被评估单

位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。

3.本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

4.评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托人及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。

5.在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：

（1）当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；

（2）当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；

（3）对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。

6.被评估单位的下属经营实体安世集团的各个子公司分布在中国大陆、菲律宾、马来西亚、德国、英国、荷兰等地，实物资产也较为集中，评估专业人员对以上境内实体进行了现场尽职调查并核查了主要资产运营状况。对境外其他国家或地区的实体，由于条件限制以及新冠疫情影响，评估专业人员没有进行现场尽职调查。对于未进行现场尽职调查实体，评估专业人员进行了函证、访谈、查阅相关财务信息等相关替代程序，并采用微信、邮件、视频会议等电子方式进行了替代核查。

7.评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是与被评估单位可实现价格的保证。

## 十二、评估报告使用限制说明

（一）本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，

本次评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。

本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。

（二）本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

（三）未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

（四）资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认是对评估对象可实现价格的保证。

（五）评估结论的使用有效期：根据国家现行规定，本资产评估报告结论使用有效期为一年，即自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日使用有效。

### 十三、评估报告日

评估报告日为二〇二〇年四月十六日。

(此页无正文)



评估机构法定代表人:

胡

资产评估师:

王

资产评估师: 郝威

二〇二〇年四月十六日

## 备查文件目录

1. 经济行为文件（复印件）；
2. 审计报告（复印件）；
3. 委托人和被评估单位企业法人营业执照（复印件）；
4. 被评估单位权属文件资料；
5. 被评估单位无形资产附表；
6. 委托人及被评估单位承诺函；
7. 签字资产评估师承诺函；
8. 中联资产评估集团有限公司资产评估资格证书（复印件）；
9. 中联资产评估集团有限公司证券期货相关业务评估资格证书（复印件）；
10. 中联资产评估集团有限公司企业法人营业执照（复印件）；
11. 签字资产评估师资格证书（复印件）。